Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук

На правах рукописи

Семянникова Алена Александровна

ЭЛЕКТРОННЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ ГЕЙСЛЕРА НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА

Специальность 1.3.8. Физика конденсированного состояния

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

> Научный руководитель доктор физико-математических наук Марченков Вячеслав Викторович

Екатеринбург – 2023

Оглавление

Введение
1 Структура, магнитные и электронные свойства сплавов Гейслера -
литературные данные12
1.1 Классификация сплавов Гейслера12
1.2 Полуметаллические ферромагнетики16
1.3 Спиновые бесщелевые полупроводники
1.4 Электронная структура сплавов Гейслера
1.5 Электронные и магнитные свойства сплавов Гейслера в состояниях
полуметаллического ферромагнетика и спинового бесщелевого
полупроводника
1.5.1 Магнитные свойства и плотность электронных состояний
1.5.2 Оптические свойства
1.5.3 Электросопротивление
1.5.4 Гальваномагнитные явления
1.5.5 Спин-поляризационные свойства
1.6 Постановка задачи
2 Образцы и методика эксперимента 40
2.1 Синтез сплавов
2.2 Аттестация структуры 40
2.3 Измерение магнитных свойств
2.4 Методика измерения электросопротивления 44
2.5 Методика измерения эффекта Холла 46
2.5.1 Нормальный эффект Холла
2.5.2 Аномальный эффект Холла
2.6 Измерение оптических постоянных 50
3 Электронные и магнитные свойства сплавов Гейслера $Co_2 YSi$ (Y = Ti, V, Cr, Mn,
Fe)
3.1 Температурные зависимости электросопротивления
3.2 Намагниченность и эффект Холла

3.3 Оптические свойства	61
3.4 Взаимосвязь электронных и магнитных свойств	
3.5 Выводы по главе 3	75
4 Электронные и магнитные свойства сплавов Гейслера Co ₂ MnZ (Z =	Al, Ga, Ge,
Si, Sn)	77
4.1 Температурные зависимости электросопротивления	77
4.2 Намагниченность и эффект Холла	
4.3 Оптические свойства	
4.4 Взаимосвязь электронных и магнитных свойств	
4.5 Выводы по главе 4	
Заключение	
Благодарности	
Публикации автора по теме диссертации	
Список литературы	

Введение

Сплавы Гейслера – это широкий класс интерметаллических соединений, большинство из которых имеют формулу *XYZ* (половинные или полугейслеровые сплавы) или X_2YZ (полные гейслеровые сплавы), где *X* и *Y* – как правило, переходные металлы, а *Z* – *s*- и *p*-элементы III-V групп таблицы Менделеева. Необычные свойства таких сплавов были обнаружены Ф. Гейслером еще в 1903 году. К настоящему времени известно около 1500 различных соединений Гейслера. Эти соединения привлекают большое внимание и интенсивно исследуются как теоретически, так и экспериментально, поскольку они обладают множеством интересных свойств, например, эффектом памяти формы, магнитокалорическим эффектом, необычными тепловыми, термоэлектрическими, полупроводниковыми свойствами и многими другими.

В 1983 году впервые было предсказано состояние полуметаллического ферромагнетизма в половинных сплавах Гейслера, таких как NiMnSb [1], в которых можно реализовать 100 % степень поляризации носителей заряда по спину на уровне Ферми. В полуметаллическом ферромагнетике для электронных состояний со спином «вверх» отсутствует щель на уровне Ферми, и соответствующие носители тока проявляют металлическое поведение, а для электронных состояний со спином «вниз» имеется щель на уровне Ферми [2]. Сплавы Гейслера с высокой степенью спиновой поляризации и высокими значениями температуры Кюри привлекают особый интерес с точки зрения спинтроники, особенно в области комнатных температур, тогда как, например, ферромагнитный полупроводник EuO, обладающий поляризованными по спину носителями заряда, имеет температуру Кюри всего $T_{\rm C} = 69$ K [3]. В настоящее время известно большое количество теоретических, а также экспериментальных работ, посвященных исследованию сплавов Гейслера в состоянии полуметаллического ферромагнетика, см., например, обзоры [4-6]. Интерес к исследованию таких материалов продолжает возрастать, поскольку область применения этих соединений шире, чем ранее обнаруженных материалов с поляризованными по спину носителями заряда.

В 2008 году был предсказан новый класс материалов – спиновые бесщелевые полупроводники [7], в которых энергетическая щель равна нулю для электронных состояний со спином «вверх», т.е. дно зоны проводимости касается потолка валентной зоны на уровне Ферми, а для электронных состояний со спином «вниз» имеется щель, как и в случае полуметаллических ферромагнетиков. Поэтому в спиновых бесщелевых полупроводниках электроны и/или дырки полностью поляризованы по спину [8]. В таких материалах существует возможность регулирования величины энергетической щели при варьировании состава, а значит, и управления электронными свойствами. К настоящему времени наиболее изученным спиновым бесщелевым полупроводником среди сплавов Гейслера является Mn₂CoAl [9]. Было обнаружено, что несколько других соединений Гейслера, таких как Cr₂ZnGe, Cr₂ZnSn, Ti₂VP, Ti₂MnAl, тоже обладают свойствами спинового бесщелевого полупроводника [10]. Состояние спинового бесщелевого полупроводника [11].

Актуальность диссертационной работы, посвященной исследованию электронных и магнитных свойств сплавов Гейслера на основе Со, связана с большим интересом научного сообщества к соединениям такого типа. В настоящее время число работ, посвященных сплавам Гейслера в состоянии полуметаллического ферромагнетика в системе Scopus превышает 3500. Температура Кюри многих сплавов Гейслера превышает комнатную, что является преимуществом по сравнению с другими материалами с высокой степенью спиновой поляризации. Сплавы Гейслера могут использоваться в спинтронике в области комнатных температур.

В работах [9, 11-16] сообщается о наблюдении состояний полуметаллического ферромагнетика и спинового бесщелевого полупроводника в сплавах Гейслера Co_2YSi (Y = Fe, Mn), Mn₂CoAl и CoFeMnSi и близкой к 100 % поляризации носителей заряда по спину. Однако систематического изучения изменения электронных транспортных, оптических и магнитных свойств таких соединений в зависимости от их состава ранее не проводилось. Для того, чтобы получить информацию об эволюции электронной структуры в настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны соединения Гейслера на основе Co, а именно, Co₂YSi,

5

где *Y*-компонента изменяется в ряду Ti, V, Cr, Mn, Fe, и Co₂MnZ, где *Z*-компонента изменяется в ряду Al, Ga, Ge, Si, Sn.

Цель работы – установление закономерностей поведения электронных и магнитных характеристик сплавов Гейслера Co_2YSi и Co_2MnZ (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe; Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn).

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Синтез соединений Гейслера $Co_2 YSi$, $Co_2 MnZ$ (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe; Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn), аттестация их кристаллической структуры.

2. Исследование электронных и магнитных свойств сплавов Co₂*Y*Si при изменении *Y*-компоненты, т.е. числа валентных 3*d*-электронов, и установление взаимосвязи между указанными характеристиками.

3. Изучение электронных транспортных, магнитных и оптических характеристик соединений Co₂MnZ при изменении Z-компоненты и установление взаимосвязи между указанными характеристиками.

Методы исследования. Для синтеза поликристаллов сплавов Гейслера использовано современное технологическое оборудование, в том числе печное, позволяющее проводить синтез образцов в различных атмосферах. Аттестация структуры синтезированных материалов выполнена на приборах и оборудовании Центра коллективного пользования ИФМ УрО РАН. Использованы растровый электронный микроскоп «QUANTA 200» с системой Pegasus для структурнотекстурного анализа EBSD и с энергодисперсионным спектрометром EDAX для элементного анализа и рентгеновские дифрактометры «ДРОН-3», «ДРОН-6» и Empyrean («PANalytical»). Измерения намагниченности и эффекта Холла выполнены на установках фирмы Quantum Design – SQUID-магнитометр MPMS-XL-5 и PPMS-9. Кроме того, для измерения эффекта Холла использовалась фирмы «Oxford Instruments». Измерение электросопротивления установка проводилось стандартным четырехконтактным методом; измерение оптических постоянных проводилось эллипсометрическим методом Битти при комнатной температуре на автоматизированной установке лаборатории оптики металлов ИФМ УрО РАН.

Научная новизна данного исследования обусловлена результатами решения поставленных задач:

1. Установлена взаимосвязь электронных транспортных характеристик, оптической проводимости и магнитных характеристик с особенностями электронной структуры в сплавах Co₂*Y*Si при последовательном изменении *Y*-компоненты в результате комплексных исследований.

2. Экспериментально обнаружено, что в сплавах Co₂MnZ при изменении Z-компоненты существуют устойчивые закономерности поведения электронных и магнитных характеристик и их взаимосвязь с плотностью электронных состояний вблизи уровня Ферми.

Научная и практическая значимость. Полученные результаты позволили установить основные закономерности поведения и взаимосвязи структурных, магнитных и электронных характеристик при изменении составов сплавов Гейслера Co_2YSi (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe) и Co_2MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn). Кроме фундаментальной важности проведенных исследований, полученные результаты могут оказаться полезными и с практической точки зрения при разработке новых материалов для спинтроники.

Положения, выносимые на защиту:

В сплавах $Co_2 YSi$ (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe) при изменении числа валентных 1. 3*d*-электронов малые значения остаточного электросопротивления И коэффициентов аномального эффекта Холла и большие величины спонтанной намагниченности и оптической проводимости наблюдаются в случае сплавов Co₂MnSi и Co₂FeSi с числом валентных электронов *z* равным 29 и 30, соответственно. Напротив, для сплавов Co₂TiSi, Co₂VSi и Co₂CrSi с z = 26, 27 и 28 наблюдаются большие значения остаточного сопротивления и аномального коэффициента Холла, сравнительно малые спонтанная намагниченность и оптическая проводимость. Обнаруженные особенности поведения электронных и магнитных характеристик можно объяснить закономерностями изменения плотности электронных состояний на уровне Ферми для этих соединений.

2. Сплавы Co₂MnSi, Co₂MnGe и Co₂MnSn имеют малое остаточное электросопротивление, а также малые величины коэффициентов нормального и аномального эффекта Холла, и относительно большие значения спонтанной намагниченности. В сплавах Co₂MnAl и Co₂MnGa значения остаточного электросопротивления, коэффициентов нормального и аномального эффекта Холла достаточно большие, а величины спонтанной намагниченности сравнительно невелики. Полученные закономерности хорошо коррелируют с плотностью электронных состояний на уровне Ферми.

3. Правило Муиджи не выполняется для сплавов Co₂VSi и Co₂CrSi: несмотря на очень большую для металлических соединений величину остаточного сопротивления $\rho_0 \sim 300$ мкОм·см в случае Co₂VSi и Co₂CrSi, температурный коэффициент сопротивления положителен во всей исследованной области температур от 4,2 K до 300 K.

Достоверность результатов обусловлена применением современных апробированных методов исследования с использованием высокочувствительной регистрирующей аппаратуры, анализом погрешностей измерений, многократной воспроизводимостью экспериментальных результатов, в том числе полученных на разных установках в различных научных центрах, и их согласием с литературными данными в случаях, когда такие данные имеются.

Апробация работы. Основные результаты докладывались лично автором на следующих международных и всероссийских конференциях: IEEE International Magnetics Conference – INTERMAG, Лион, Франция, 2021; 65th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM 2020), Флорида, США, 2020; VII Euro-Asian Symposium «Trends in Magnetism» (EASTMAG-2019), Екатеринбург, 2019; International Conference Functional Materials (ICFM 2021), Крым, 2021; VIII Международной молодежной научной школе-конференции Современные проблемы физики и технологий, Москва, 2019; Двадцать пятой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-25), Крым, 2019; Всероссийской школе-семинаре по проблемам физики конденсированного состояния вещества (СПФКС-19, 20), Екатеринбург, 2018, 2019.

8

Диссертационная работа выполнена в рамках государственного задания МИНОБРНАУКИ России (тема «Спин» № 122021000036-3) при поддержке гранта РФФИ 20-32-90065, в котором автор выступал в качестве исполнителя.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 статей в научных журналах, определенных Перечнем ВАК и индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science.

Личный вклад. В диссертации изложены экспериментальные результаты, полученные лично автором, а также под руководством и совместно со своим научным руководителем. Автор принимал непосредственное участие в формулировке цели и задач исследований, проведении экспериментальных исследований, обработке экспериментальных данных, в обсуждении полученных результатов, формулировке основных выводов, написании статей и тезисов докладов и их представлении на конференциях различного уровня. Сплавы Гейслера $Co_2 YSi$ (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe) изготовлены к.ф.-м.н. П.Б. Терентьевым, сплавы Гейслера Co_2MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn) – в секторе синтеза сплавов и монокристаллов ИФМ УрО РАН (к.т.н. Ю.Н. Акшенцев, к.т.н. Д.И. Давыдов). Расчеты плотности электронных состояний выполнены к.ф.-м.н. А.В. Лукояновым. Автор принимал непосредственное участие в проведении структурной аттестации образцов под руководством к.ф.-м.н. Е.Б. Марченковой и к.х.н. Е.И. Патракова, подготовке образцов к измерениям электронных транспортных и магнитных свойств, проведении измерений. Измерения температурных зависимостей электросопротивления проведены автором лично. Оптические свойства изучались совместно с к.ф.-м.н. Е.И. Шредер. Часть магнитных измерений и измерений эффекта Холла проводились в Атоминституте Технического университета Вены (Австрия) (д.ф.-м.н. В.В. Марченков, Н.W. Weber, М. Eisterer), Шанхайского электроэнергетического университета (Китай) (Т. Gao), а также в Центре коллективного пользования ИФМ совместно с д.ф.-м.н. В.Н. Неверовым, к.ф.-м.н. А.В. Королевым. Автором лично выполнена основная часть обработки полученных данных. Статьи по теме диссертации написаны автором совместно с соавторами.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения. Текст диссертации, включая 46 рисунков и 12 таблиц, занимает 110 страниц. Список литературы содержит 72 наименования.

Соответствие диссертации паспорту специальности. Содержание диссертации соответствует пункту 1 «Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы и свойств неорганических и органических соединений как в кристаллическом (моно- и поликристаллы), так и в аморфном состоянии, в том числе композитов и гетероструктур, в зависимости от их химического, изотопного состава, температуры и давления» Паспорта специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния.

Основное содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках диссертационной работы, формулируется цель, ставятся задачи исследования, отмечается научная новизна практическая И значимость представляемой работы.

В первой главе приводится краткий обзор научной литературы и современного состояния теоретических и экспериментальных исследований сплавов Гейслера на основе Со. Особое внимание уделено состояниям полуметаллического ферромагнетика и спинового бещелевого полупроводника, которые могут реализоваться в сплавах Гейслера. Подробно рассматриваются литературные данные об особенностях их электронной зонной структуры, а также о поведении электронных и магнитных свойств таких соединений. В конце главы сформулирована постановка задачи диссертационного исследования.

Во второй главе представлены методы синтеза сплавов и приготовления образцов исследуемых соединений Гейслера Co₂*Y*Si, Co₂Mn*Z* (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe; Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn). Рассматриваются методики и оборудование для проведения измерений электрических, магнитных, оптических свойств и эффекта Холла. Приводятся результаты аттестации исследуемых образцов сплавов Гейслера Co₂*Y*Si, Co₂Mn*Z* (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe; *Z* = Al, Ga, Ge, Si, Sn).

10

Третья глава посвящена исследованию свойств сплавов Гейслера Co₂*Y*Si (*Y* Ti. V. Cr. Mn. Fe). Приводятся температурные зависимости =электросопротивления, полевые зависимости сопротивления Холла И намагниченности, результаты измерений оптических постоянных. Проведено разделение нормальной и аномальной составляющих эффекта Холла, сделана оценка концентрации и подвижности основных носителей заряда. Проведено сопоставление полученных экспериментальных данных с результатами расчетов электронной зонной структуры этих соединений.

В четвертой главе приводятся результаты комплексных исследований сплавов Гейслера Co_2MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn). Проведены измерения электросопротивления, намагниченности, сопротивления Холла. Приводятся результаты измерений дисперсии реальной и мнимой частей диэлектрической постоянной, дисперсии оптической проводимости и отражательной способности данных соединений. Проведена оценка нормального и аномального коэффициентов Холла, концентрации и подвижности носителей тока. Полученные экспериментальные данные сопоставлены с результатами расчетов электронной зонной структуры.

В заключении представлены основные результаты и выводы, полученные в диссертационной работе.

1 Структура, магнитные и электронные свойства сплавов Гейслера – литературные данные

В настоящей главе приводятся литературные данные о классификации, структурных особенностях, электрических, магнитных и гальваномагнитных свойствах сплавов Гейслера. Детально описаны состояния полуметаллического ферромагнетика и спинового бесщелевого полупроводника, которые могут реализоваться в сплавах Гейслера. Приведены основные методы определения степени спиновой поляризации носителей тока. В конце главы сформулирована постановка задачи диссертационного исследования.

1.1 Классификация сплавов Гейслера

Немецкий химик Ф. Гейслер (F. Heusler) еще в 1903 году обнаружил, что сплавление неферромагнитных в чистом виде Mn, Cu и Al в соединение Cu₂MnAl привело к появлению в нем большой спонтанной намагниченности [17]. Впоследствии данная особенность была обнаружена и в других тройных интерметаллических соединениях с общей химической формулой X_2YZ («полные» сплавы Гейслера) или со стехиометрическим соотношением между элементами *XYZ* («половинные» сплавы Гейслера), а также в четверных сплавах *XX*'*YZ*. Как правило, *X* и *Y* – переходные металлы, а Z – *s*-, *p*- элементы III-V групп таблицы Менделеева. В настоящее время известно более 1500 интерметаллических соединений, которые входят в это семейство. Элементы, которые могут входить в сплавы Гейслера показаны на рисунке 1.1.

В зависимости от состава сплавы Гейслера проявляют большое разнообразие необычных магнитных, электрических, оптических и механических свойств. Примерами таких свойств являются эффект памяти формы, эффекты сверхупругости и сверхпластичности, магнитокалорический эффект, эффект гигантского магнитосопротивления и др. [4].



Рисунок 1.1 – Компоненты сплавов Гейслера [4]

Сплавы Гейслера проявляют и ряд других интересных свойств. Например, присутствие вблизи уровня Ферми $E_{\rm F}$ электронных состояний только с одним направлением спина, т.е. 100 % спиновую поляризацию; свойства топологических изоляторов; аномальную последовательность магнитных переходов, где при нагреве сплава он переходит из немагнитного состояния в магнитное [4, 5], в отличие от «классических» ферромагнетиков, когда нагрев разрушает ферромагнитное упорядочение, и при определенной температуре ферромагнетик переходит в немагнитное состояние.

Тройные сплавы с общей формулой *XYZ* имеют кубическую решетку с пространственной группой C1_b (\mathbb{N} 216). Характерная структура «половинных» сплавов Гейслера представляет собой три взаимопроникающих ГЦК-подрешетки, каждая из которых занята атомами *X*, *Y* и *Z* [4], как показано на рисунке 1.2 (а).

Полные сплавы Гейслера с общей химической формулой X_2YZ имеют кристаллическую структуру $L2_1$ (№ 225), которая состоит из четырех взаимопроникающих ГЦК-решеток (рисунок 1.2 (б)). Атом в центре решетки отличается от атомов в ее углах, и прилегающие кубы имеют различные атомы в центре решетки. В координатах Вайкоффа элементы X занимают позиции (0,25;

0,25; 0,25) и (0,75; 0,75; 0,75), атомы *Y* имеют положение (0; 0; 0), а *Z* – (0,5; 0,5; 0,5). Данная структура впервые была установлена в Cu₂MnAl O. Гейслером [4, 18].



Рисунок 1.2 – (а) Структура «половинных» сплавов Гейслера; (б) структура полных сплавов Гейслера [4]

Существуют также так называемые инверсные сплавы Гейслера со структурой кристаллической решетки Х_А (№ 216) [6]. Сплав может иметь инверсную кристаллическую решетку, если атомный номер У-компоненты выше, чем Х-компоненты того же периода таблицы Менделеева. Кроме того, инверсная структура также может появляться в соединениях с переходными металлами компонента Х разных периодов, В ЭТОМ случае должна быть более электроположительна, чем Ү. Инверсная структура также описывается четырьмя взаимопроникающими подрешетками ГЦК, однако, компоненты Х и У меняются местами. В координатах Вайкоффа атомы Х оказываются на позиции (0; 0; 0) и (0,75; 0,75; 0,75), атомы У занимают позиции (0,5; 0,5; 0,5), а Z имеют положение (0,25; 0,25; 0,25). Прототипом этой структуры является CuHg₂Ti [4].

На сегодняшний день сплавы Гейслера рассматриваются как перспективные материалы для применения в спинтронике. Особое внимание привлекают сплавы Гейслера в состояниях, близких к полуметаллическим ферромагнетикам (ПМФ) и спиновым бесщелевым полупроводникам (СБП). На рисунке 1.3 приведен схематический вид электронной зонной структуры ПМФ и СБП. Занятые уровни обозначены закрашенными областями. Стрелки означают электронные состояния

с направлениями спина «вверх» (↑) и спина «вниз» (↓). Далее в разделах 1.2 и 1.3 данные состояния рассматриваются более подробно.

На практике строго реализовать условия возникновения состояний ПМФ и, особенно, СБП непросто, однако, имеются работы, в которых сообщается о наблюдении ПМФ- и СБП-состояний в сплавах Гейслера, напр., [9, 11, 12].



Рисунок 1.3 – Схематический вид плотности состояний *N*(*E*) как функции энергии *E*: (а) ПМФ; (б) СБП

Стоит отметить преимущества соединений Гейслера с точки зрения в спинтронике. Во-первых, постоянная кубической решетки применения соединений Гейслера близка к значениям Si и Ge. В результате облегчается задача соединить сплав Гейслера и полупроводник для инжекции спин-поляризованного электрона в полупроводниковый канал. Во-вторых, многие из ПМФ соединений Гейслера имеют довольно высокое значение температуры Кюри (намного выше комнатной температуры), что помогает уменьшить термическую деполяризацию спинов при комнатной температуре. Например, ПМФ Co₂FeSi имеет температуру Кюри выше 1000 K, а постоянная его решетки соответствует GaAs в пределах 0,08 %. Кроме того, *E*_F и запрещенная зона могут быть легко «настроены» в сплавах Гейслера помощью соответствующего с легирования, ЧТО позволяет оптимизировать материал для конкретного применения.

Можно предположить, что полные соединения Гейслера на основе кобальта $(Co_2YZ, Y = Mn, Fe, V u \tau.g. u Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn)$ являются наиболее заметными кандидатами на роль ПМФ. В [12] сообщается об исследовании спиновой поляризации тонкопленочного образца Co_2MnSi толщиной 30 нм, выращенного на монокристаллической подложке MgO (100). С помощью ультрафиолетовой фотоэмиссионной спектроскопии со спиновым разрешением обнаружено очень большое значение (93 %) спиновой поляризации при комнатной температуре [10].

1.2 Полуметаллические ферромагнетики

В 80-е годы XX века исследования электронной зонной структуры некоторых сплавов Гейслера привели К открытию состояния полуметаллического ферромагнетизма [1, 6, 18-20], которое заключается в том, что в электронном энергетическом спектре вблизи уровня Ферми E_F для одного направления спина, ориентированного против направления намагниченности, т.е. спина «вниз», присутствует широкая энергетическая щель (~ 1 эВ), а для спина «вверх» запрещенной зоны на *E*_F не наблюдается. Такое состояние представляет большой интерес, потому что имеются полностью спин-поляризованные электронные состояния вблизи $E_{\rm F}$ [4, 6] (рисунок 1.3 (a)). В 1983 году [1] впервые был предсказан полуметаллический ферромагнетизм в NiMnSb и возможная реализация 100 % степени поляризации носителей заряда по спину.

Для достижения полной спиновой поляризации должны выполниться следующие условия: нулевая температура и отсутствие спин-орбитального взаимодействия. Так как в большинстве сплавов Гейслера, содержащих 3*d*-элементы, не наблюдается спин-орбитальное взаимодействие, то они являются кандидатами для проявления полуметаллического ферромагнетизма [4].

Для ПМФ-соединений справедливо так называемое правило Слэтера-Полинга: при добавлении в соединение одного валентного электрона он занимает только состояния со спином «вверх», а общий спиновый магнитный момент увеличивается примерно на 1 µ_B [21, 22]. Поскольку в электронной структуре таких соединений имеется щель для плотности состояний со спином «ВНИЗ», следовательно, число электронов co спином «вверх» увеличивается пропорционально общему числу электронов. На основе правила Слэтера-Полинга [21] можно оценить магнитный момент М 3d-элементов в зависимости от числа z валентных электронов на элементарную ячейку. Числом валентных электронов называется сумма количества электронов, которые находятся за пределами оболочки элементов, последней заполненной составляющих соединение. Магнитный момент линейно зависит от числа валентных электронов [4, 23], как показано на рисунке 1.4 на примере соединений Гейслера на основе Со.

Общее число *z* валентных электронов на элементарную ячейку определяется суммой числа электронов со спином «вверх» $n\uparrow$ и «вниз» $n\downarrow$, а магнитный момент *М* определяется их разностью (1.1) [22]:

$$z = n\uparrow + n\downarrow;$$
 $M = (n\uparrow - n\downarrow) \mu_{\rm B}; M = (z - 2n\downarrow) \mu_{\rm B}$ (1.1)



Рисунок 1.4 – Правило Слэтера-Полинга [4]

Для полных сплавов Гейслера со структурой $L2_1 M = (z - 24) \mu_B$ по причине того, что для электронных состояний со спином «вниз» содержится 12 электронов

на элементарную ячейку: 4 занимают низколежащие *s*- и *p*-зоны элемента *sp* и 8 электронов *d*-группы, что соответствует щели вблизи уровня Ферми [22]. В половинных сплавах полный магнитный момент определяется соотношением $M = (z - 18) \mu_B$, так как электронные состояния со спином «вниз» имеют 9 валентных электронов. Правило Слэтера-Полинга является простым, но эффективным инструментом для прогнозирования состояний полуметаллического ферромагнетизма [4, 6, 10].

Высокие значения температуры Кюри T_C, магнитного момента и спиновой поляризации носителей заряда демонстрируют соединения Co₂FeSi и Co₂MnSi [12, 14]. Со₂FeSi имеет самую высокую температуру Кюри T_C ~ 1100 К среди всех соединений Гейслера, обладающих свойствами полуметаллических ферромагнетиков, о которых сообщалось до сих пор. Кроме того, Co₂FeSi (число валентных электронов z = 30) имеет момент насыщения, близкий к 6 μ_B , что хорошо согласуется со значением, полученным по правилу Слэтера-Полинга $M = (z - 24) \mu_{\rm B}$ для полных сплавов Гейслера, и позволяет предсказать проявление в этом соединении свойств ПМФ. В работе [24] сообщается об измерениях температурных зависимостей электросопротивления $\rho(T)$ в монокристаллах Co₂FeSi. В результате обнаружен «металлический» тип проводимости во всем температурном диапазоне, остаточное сопротивление $\rho_0 \approx 4$ мкОм·см. Сопротивление Холла для Co₂FeSi имеет линейную зависимость от H, но с сильным изломом вблизи H = 4 к \Im при T =25 К, 100 К и 300К [10, 24].

Исследование магнитных свойств серии сплавов Co₂MnZ (Z = Al, In, Ga, Ge, Sb, Sn, Si) впервые позволило установить, что существуют сплавы Гейслера, в которых не только атомы Mn, но и другие атомы (например, Co) могут обладать существенным магнитным моментом. Характерными особенностями данных сплавов являются большой магнитный момент и высокие температуры Кюри [25]. В работе [22] в полных сплавах Гейслера Co₂MnZ (Z = Al, Si, Ge) на основе зонных расчетов структуры также были предсказаны свойства ПМФ.

Взаимодействие Со-Со играет ключевую роль в появлении полуметаллического ферромагнетизма. Расчеты зонной структуры показали, что в

некоторых соединениях Гейслера на основе Со уровень Ферми находится в середине запрещенной зоны для электронных состояний со спином «вниз», что делает полуметаллический ферромагнетизм устойчивым к температурным флуктуациям [4].

В работе [19] впервые сообщается об исследовании электронной структуры сплавов Гейслера на основе Co: Co₂MnSn, Co₂TiSn и Co₂TiAl. Расчеты *ab-inito* [20] выявили, что плотность состояний на E_F ферромагнитных Co₂MnSn и Co₂MnAl становится практически нулевой для одного направления спина, что может приводить к высокой спиновой поляризации. Авторами [20] был сделан вывод, что это является причиной специфических транспортных свойств.

Расчеты электронной структуры соединения Гейслера Co₂MnGe, приведенные в работе [26], показывают наличие щели на E_F для электронных состояний с направлением спина «вниз», что согласуется с правилом Слэтера-Полинга. ПМФ Co₂MnGe считается одним из наиболее подходящих кандидатов для спинтроники, поскольку он имеет высокую температуру Кюри $T_C = 905$ K.

Со₂MnGa (z = 28) представляет собой полуметаллический ферромагнетик с относительно высоким значением температуры Кюри $T_{\rm C} = 694$ К. Намагниченность насыщения близка к 4 $\mu_{\rm B}/\phi$.е. (ϕ .е. – ϕ ормульная единица), подчиняясь правилу Слэтера-Полинга. Температурные зависимости электросопротивления $\rho(T)$ объемного образца Со₂MnGa имеют «металлический» тип [10].

Магнитный вклад в сопротивление обычных ферромагнитных металлов определяется одно-магнонными процессами согласно формуле (1.2) [27, 28]:

$$\rho(T) \sim T^2 N \uparrow (E_F) N \downarrow (E_F) \exp(-T/T^*)$$
(1.2)

где $N\uparrow$, $N\downarrow$ - плотность электронных состояний со спином «вверх» и «вниз», соответственно, $T^* \sim q_1^2 T_C$ характерный масштаб для этих процессов, $q_1 \sim \Delta/v_F$, v_F – скорость носителя заряда на E_F , Δ – спиновое расщепление (энергетическая щель).

Данный вклад отсутствует для ПМФ-соединений, так как $N\downarrow(E_{\rm F}) = 0$. Поскольку при нулевой температуре в ПМФ существуют состояния только с одной проекцией спина на $E_{\rm F}$, одномагнонные процессы рассеяния в спин-волновой области температур запрещены и T^2 -член в сопротивлении (1.2) отсутствует. В случае ПМФ сопротивление определяется двухмагнонными процессами рассеяния [2, 27, 29]. Двухмагнонные процессы рассеяния приводят к степенному закону температурной зависимости электросопротивления $\rho(T) \sim T^p$, а также к отрицательному линейному магнитосопротивлению. Как правило, p = 7/2 и p = 9/2 при достаточно низких температурах [28, 30, 31].

Результаты зонных расчетов плотности электронных состояний позволяют определить наличие щели на $E_{\rm F}$ для носителей со спином «вниз», в то время как для носителей со спином «вверх» щель отсутствует, таким образом делается вывод о проявлении ПМФ-состояния и рассчитывается степень спиновой поляризации [32]. Определить величину спиновой поляризации P также позволяют экспериментальные методы, которые подробнее рассматриваются в разделе 1.5.5.

1.3 Спиновые бесщелевые полупроводники

В 2008 году был предсказан новый класс материалов – спиновые бесщелевые полупроводники [7]: в СБП присутствует широкая ($\Delta E \sim 1 \text{ eV}$) щель вблизи E_F для электронных состояний с одним направления спина, а для электронных состояний с противоположным направлением спина имеется нулевая энергетическая щель [33], как показано на рисунке 1.3 (б).

СБП значительно отличаются от обычных полупроводников, изоляторов и металлов. Они также имеют отличные характеристики по сравнению со свойствами ПМФ и недавно открытых топологических изоляторов, полуметаллов Дирака и Вейля. Как показано в [8], основные характеристики СБП заключаются в следующем: для возбуждения носителей заряда требуется небольшая энергия; полностью поляризованные по спину носители заряда могут генерироваться световым возбуждением или термической активацией; носители заряда полностью поляризованы по спину; под действием магнитного поля полностью

поляризованные по спину электроны или дырки могут перемещаться к краю тонких образцов за счет эффекта Холла [8].

Среди сплавов Гейслера особый интерес вызывает соединение Mn₂CoAl, так как в нем первом наблюдалось СБП-состояние [9]. Mn₂CoAl имеет 26 валентных электронов и кристаллизуется в структуре X_A , с $T_C \approx 720$ К. По правилу Слэтера-Полинга для Mn₂CoAl (z = 26) магнитный момент составляет $M = 2 \mu_B/\phi$.е. при T <5 К, что подтверждается экспериментальными данными. Электропроводность $Mn_2CoAl \sigma(T)$, как сообщают в [9], соответствует полупроводниковому поведению во всем температурном диапазоне со значением 2440 См/см при 300 К. Интересно, что $\sigma(T)$ линейно растет с ростом T с температурным коэффициентом проводимости ~ $-1,4\cdot10^{-9}$ Ом·м·К⁻¹. Хотя магнитосопротивление выше 200 К является отрицательным, оно меняет знак и становится положительным уже при Т = 100 К. Магнитосопротивление линейным образом зависит от поля во всем исследованном диапазоне температур, не является насыщающимся и достигает значения около 10 % при T = 2 К при индукции магнитного поля B = 9 Тл. Обнаружена низкая концентрация носителей заряда ~1,3-2·10¹⁷ см⁻³ в диапазоне температур 2 – 300 К. Зонная структура Mn₂CoAl имеет ожидаемый полупроводниковый характер [10]. После экспериментальной работы [9] появилась работа [34], в которой авторы исправили свои неточности относительно значений проводимости и концентрации носителей тока.

Другие соединения Гейслера, такие как Cr_2ZnGe , Cr_2ZnSn , Ti_2VP , Ti_2MnAl , также представляют собой СБП [10]. Перспективными материалами со свойствами СБП являются четверные сплавы Гейслера LiMgPdSn-типа [8]. На основе расчетов из первых принципов и экспериментов состояние СБП предполагается в четверном соединении Гейслера CoFeCrGa. Данный материал был исследован с помощью мессбауэровской спектроскопии, а также были проведены измерения намагниченности и электронных транспортных свойств. Это соединение может превращаться из СБП в ПМФ под давлением благодаря своей электронной структуре [8].

В [6] высказано предположение, что существует связь между полуметаллами Вейля и СБП. СБП, как правило, появляются только в пространственной группе № 216, тогда как для того же количества валентных электронов соответствующие соединения Гейслера в пространственной группе № 225 являются полуметаллами Вейля, в которых валентная зона и зона проводимости линейно соприкасаются, что приводит к появлению конусов Вейля. Структуры зон для носителей со спином «вниз» для соответствующих материалов идентичны в обеих пространственных группах, но в пространственной группе № 225 формируется запрещенная зона, и поэтому вместо полуметалла Вейля получается полупроводниковый канал для носителей со спином «вверх». Гигантский аномальный эффект Холла был обнаружен в полных сплавах Гейслера Со₂MnAl и Co₂MnGa. Нарушая симметрию относительно обращения времени, полуметаллы Вейля могут существовать в различных магнитных материалах Гейслера, таких как Co₂MnAl, в которых расположением и количеством точек Вейля можно управлять, изменяя ориентацию намагниченности [5].

1.4 Электронная структура сплавов Гейслера

Расчеты *ab initio*, основанные на теории функционала плотности, вносят существенный вклад в понимание фундаментальных электронных и магнитных свойств сплавов Гейслера. В работе [35] выполнены расчеты электронной структуры для полных сплавов Гейслера со структурой *L*2₁ на основе Со с целью выяснения происхождения щели для электронных состояний со спином «вниз» в ПМФ.

В работе [22] приводятся плотности состояний для большого количества половинных сплавов Гейслера, а также для полных сплавов Co₂MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn), которые предположительно являются ПМФ с небольшой щелью для электронных состояний со спином «вниз», величина которой ~ 0.1 – 0.3 эВ. В полных сплавах Гейслера магнитный момент Со достаточно большой и положительный. Атомы *s*- и *p*-элементов имеют очень малый отрицательный момент, который на порядок меньше момента Co.

Соединения Co₂MnZ, содержащие Al и Ga, имеют 28 валентных электронов, а соединения, содержащие Co₂MnSi, Co₂MnGe и Co₂MnSn имеют 29 валентных электронов. Первые соединения имеют общий магнитный момент 4 µ_B, а вторые — 5 µв. В этих соединениях, как и в половинных сплавах Гейслера, четыре зоны spэлемента расположены намного ниже уровня Ферми и, таким образом, не имеют отношения к щели. Атомы Со образуют простую кубическую решетку и являются соседями, следующими за ближайшими, гибридизация между этими атомами качественно очень важна, также учитывается гибридизация данных Со-Со орбиталей с *d*-орбиталями Mn. Таким образом, корреляция между числом валентных электронов и спиновым моментом происходит согласно правилу Слэтера-Полинга. Существенной для образования щели вблизи E_F является *d*-*d*гибридизация между переходными атомами, составляющими сплавы Гейслера. В случае половинных сплавов Гейслера, например, NiMnSb, щель создается за счет гибридизации и расщепления между состояниями d Mn и d Ni. В случае полных например, Co₂MnSi щель возникает в результате гейслеровых сплавов, гибридизации *d*-состояний двух атомов Со и последующего взаимодействия этих гибридов с *d*-состояниями Mn. Из-за различного обменного расщепления различных атомов в элементарной ячейке гибридизация состояний со спином «вверх» не показывает такой же картины, как для состояний со спином «вниз». Таким образом, щель появляется только для электронных состояний с направлением спина «вниз», а для направления спина «вверх» состояния являются заполненными [22].

Согласно [36], среди трех возможных ПМФ Co_2MSi (M = Ti, V, Cr) соединение с Cr является наиболее интересным из-за его плотности состояний со спином «вверх» с наибольшим значением энергии Ферми из всех известных ПМФ. Причина такого большого значения в том, что уровень Ферми «пересекают» сильно локализованные состояния в основном Cr-*d*-подобного характера. Вклад *d*-состояний Co очень мал. Таким образом, Co₂CrSi представляет собой ПМФ, который обеспечивает 100 % спиновую поляризацию. Это состояние отличается от

известных ПМ Φ Co₂MnSi и Co₂FeSi, для которых состояния при E_F носят более делокализованный характер.

В работе [37] проведены расчеты электронных структур четырех сплавов Гейслера на основе кобальта с общей формулой Co₂MnZ (где Z = Si, Ge, Ga, Al) с помощью теории функционала плотности (DFT) с обменно-корреляционным функционалом в обобщенном градиентном приближении (GGA) версии Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [38, 39]. Важным фактором для возможного практического применения ПМФ является величина щели вблизи E_F для электронных состояний со спином «вниз». Небольшие щели могут быть легко разрушены температурными воздействиями. Состояние полуметаллического ферромагнетика также может быть легко нарушено, если E_F расположен близко к краям зон: либо валентной зоны для электронных состояний со спином «вниз», либо зоны проводимости. В Co₂MnAl и Co₂MnGa E_F находится за пределами запрещенной зоны. В случае Co₂MnGe E_F близок к потолку валентной зоны, тогда как для Co₂MnSi он находится в центре щели.

1.5 Электронные и магнитные свойства сплавов Гейслера в состояниях полуметаллического ферромагнетика и спинового бесщелевого полупроводника

1.5.1 Магнитные свойства и плотность электронных состояний

Полные сплавы Гейслера, содержащие Со, как правило, являются ферромагнетиками с высокими температурами Кюри (выше 600 К) и упорядочены в структуре $L2_1$. В сплавах Co₂MnZ каждый атом Mn или *s*- и *p*-элемент имеет восемь атомов Со в качестве первых соседей, находящихся в положении октаэдрической симметрии, в то время как каждый атом Со имеет четыре атома Mn и четыре *sp*-атома в качестве первых соседей. Окружение атомов Со в одной подрешетке такое же, как окружение второй, но повернутое на 90°. Заполнение двух ГЦК-подрешеток атомами Со (или вообще компоненты *X*) отличает полные

сплавы Гейслера со структурой $L2_1$. Хотя в структуре $L2_1$ атомы Со являются соседями второго порядка, их взаимодействие формирует магнитные свойства этих соединений. Как правило, *s*- и *p*-элементы не играют определяющей роли при формировании щели для электронных состояний со спином «вниз», но тем не менее, влияют на физические свойства и структурную стабильность сплавов Гейслера [40]. Магнитные моменты каждого типа ионов могут зависеть от рассматриваемого типа кристаллической структуры [41], используемого вида обменно-корреляционного потенциала (метод *ab initio*) и эффектов структурного беспорядка [42].

1.5.2 Оптические свойства

Взаимодействие электромагнитного поля световой волны с металлом описывается системой уравнений Максвелла. Оптические свойства металла определяются комплексной диэлектрической проницаемостью (1.3):

$$\varepsilon = \varepsilon_1 - i\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - i4\pi\sigma/\omega \tag{1.3}$$

Действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости определяет в заданном поле величину электростатической индукции $D=\varepsilon_1 E$, мнимая часть – плотность электрического тока $J=\sigma E$. В случае изотропного металла ε_1 и σ – скалярные величины, E – напряженность электрического поля, ω – частота падающего света [43, 44].

В металлах и сплавах существует два основных механизма, определяющих оптические свойства: внутризонное поглощение и межзонное поглощение электронов. Комплексная диэлектрическая проницаемость представляет собой сумму вкладов от этих механизмов, которые могут сосуществовать в некоторой области энергий. В инфракрасной области спектра основную роль играет механизм внутризонного поглощения света в пределах одной полосы [45]. Его вклад определяется параметрами электронов проводимости – плазменной частотой Ω и частотой релаксации γ , и уменьшается пропорционально квадрату частоты падающего света ω . Данный механизм проявляется на оптических кривых следующим образом. Для диэлектрической проницаемости – отрицательные значения ε_1 , рост ε_2 и модуля ε_1 с уменьшением энергии или увеличением длины волны падающего света описываются формулами Друде (1.4, 1.5):

$$\varepsilon_1 = 1 - \frac{\Omega^2}{\omega^2 + \gamma^2}; \tag{1.4}$$

$$\varepsilon_2 \cdot \omega = \frac{\Omega^2 \cdot \gamma}{\omega^2 + \gamma^2} \tag{1.5}$$

Подъем кривой оптической проводимости $\sigma(\omega)$ с уменьшением энергии падающего света, так называемый друдевский подъем, описывается формулами Друде (1.4, 1.5). Друдевский подъем характерен для металлических соединений [45]. Таким образом, критерием металлического типа зонного спектра является отрицательное значение действительной части диэлектрической проницаемости $\varepsilon_1(\omega)$ в области низких частот и Друде-подобный рост $\sigma(\omega)$ при $\omega \to 0$.

В видимой и ультрафиолетовой области доминирует квантовое поглощение света с перебросом электронов из нижних энергетических состояний в свободные верхние – межзонное поглощение [45]. Межзонное поглощение формирует различные пики и наплывы на кривой $\sigma(\omega)$, которые могут начинать появляться уже на фоне друдевского подъема. В видимой и ультрафиолетовой области благодаря межзонному поглощению формируется основная полоса поглощения. Электрон перебрасывается с одной полосы, находящейся ниже уровня Ферми на другую, лежащую выше E_F , а затем возвращается назад. В работе [46] в некоторых сплавах Co₂MnZ, Z = Al, Ga, Sn, Si, Sb, например, в Co₂MnAl было обнаружено отсутствие друдевского подъема и высокий уровень межзонного поглощения в инфракрасной области спектра вплоть до границы исследованного интервала. Такое поведение оптических функций является аномальным для металлических систем, но, как оказалось, согласуется с аномальным поведением электросопротивления этого соединения.

На рисунке 1.5 приведена оптическая проводимость сплавов Co₂YAl, Fe₂YZ [47]. Видно, что изменение Y- и Z-компонент проявляется в оптической проводимости различным образом. Для Co₂TiAl и Fe₂TiAl в инфракрасной области наблюдается друдевский подъем, что говорит о хорошей «металличности» данных соединений. Для остальных сплавов друдевский вклад отсутствует на всей исследованной области спектра.



Рисунок 1.5 – Оптическая проводимость сплавов Гейслера на основе Со и Fe [47]

1.5.3 Электросопротивление

Электрическое сопротивление в металлах возникает из-за рассеяния электронов проводимости на тепловых колебаниях решетки (электрон-фононное рассеяние), на примесях, на дефектах, связанных с механическими деформациями (дислокации, вакантные узлы), магнонах и других рассеивающих центрах. Вклады в удельное электросопротивление, определяемое как величина, обратная проводимости, обусловленные этими различными причинами, аддитивны [48]. Удельное электросопротивление *ρ* магнитных металлов определяется выражением (1.6):

$$\rho(T) = \rho_0 + \rho_{\rm ph}(T) + \rho_{\rm mag}(T) + \rho_{\rm e-e}(T), \qquad (1.6)$$

где ρ_0 – температурно-независимое остаточное электросопротивление, причиной которого является рассеяние электронов на примесях и дефектах решетки. $\rho_{ph}(T)$ – вклад от рассеяния электронов проводимости на фононах, а $\rho_{mag}(T)$ представляет собой электрон-магнонное рассеяние в магнитоупорядоченном состоянии. $\rho_{e-e}(T)$ означает вклад электрон-электронного рассеяния и, как правило, он мал по сравнению с другими вкладами, кроме того, данный член имеет зависимость T^2 при низких температурах. Удельное сопротивление от рассеяния электронов проводимости на фононах может быть выражено соотношением Блоха-Грюнайзена (1.7):

$$\rho_{\rm ph}(T) = c \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^S \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \frac{x^s \exp\left(x\right) dx}{\left[\exp(x) - 1\right]^2},\tag{1.7}$$

где $\Theta_{\rm D}$ – температура Дебая, c – константа. Для простых металлов s = 5, и $\rho_{\rm ph}$ имеет зависимость T^5 при низких температурах $T \ll \Theta_{\rm D}$. При высоких температурах сопротивление является линейной функцией температуры.

В магнитных материалах рассеяние электронов проводимости на магнитных моментах также учитывается в удельном сопротивлении. Простейшая модель такого рассеяния предполагает обменное взаимодействие между свободными электронами и локализованными магнитными моментами: электроны проводимости в *s* полосе рассеиваются флуктуациями *d* электронов. В ферромагнитных материалах вклад ρ_{mag} не зависит от температуры при $T >> T_{\rm C}$. Однако он уменьшается при T ниже $T_{\rm C}$ благодаря уменьшению спин-

разупорядоченного рассеяния с развитием магнитного порядка. Поведение ρ ниже $T_{\rm C}$ может объясняться на основе рассеяния электронов проводимости на спиновых волнах, и будет следовать закону $\rho_{\rm mag} \sim T^2$ при низких температурах $T \ll T_{\rm C}$. Для многих магнитных металлов температурная зависимость электросопротивления при очень низких температурах часто отклоняется от простого квадратичного закона и определяется законом (1.8):

$$\rho = \rho_0 + AT^{\alpha},\tag{1.8}$$

где α – это показатель степени. Отклонение от α = 2 происходит за счет фононной части, которая в сочетании с законом T^2 дает $\alpha \neq 2$.

В случае фазового перехода второго рода от парамагнетика к ферромагнетику при температуре Кюри ρ может изменять наклон или на зависимости $\rho(T)$ появляются точки перегиба, в то время как $d\rho/dT$ демонстрирует степенное поведение (~ T^{ξ}) вблизи критической точки, где ξ является критическим показателем. Аномалия электросопротивления в критической области возникает из-за рассеяния электронов проводимости с короткодействующими критическими флуктуациями в окрестности $T_{\rm C}$.

В полупроводниках транспорт заряда при высокой температуре, как правило, подчиняется термически активируемому поведению типа Аррениуса (1.9):

$$\rho(T) \propto \exp(\mathbf{E}_{\rm a}/\mathbf{k}_{\rm B}T),\tag{1.9}$$

где k_B – постоянная Больцмана, E_a – энергия активации, которая в данной модели не зависит от температуры [10].

Электронные свойства сплавов Гейслера на основе Co_2YAl , Co_2FeZ , Fe_2YZ подробно изучались в работах [15, 28, 49-52]. В работе [15] были проведены комплексные исследования электрических, магнитных и гальваномагнитных свойств сплавов Гейслера Co_2YAl и Co_2FeZ при изменении Y- и Z-компоненты, то есть при изменении числа 3d валентных электронов, и *sp*-элементов,

соответственно. На рисунке 1.6 приведены температурные зависимости электросопротивления сплавов Co₂YAl, Co₂FeZ [15].

Видно, что изменение У- и Z-компонентов в данных сплавах Гейслера различным образом проявляется в электрических свойствах данных материалов. Так, при изменении элемента У изменения в поведении электросопротивления оказываются кардинальными, а при изменении Z наблюдаемые изменения менее очевидны. Как показано в [15, 28], изменение У-компоненты в сплавах Со₂YAl и Fe₂YZ приводит к сильным изменениям в величине остаточного сопротивления и виде температурных зависимостей электросопротивления, сильно влияет на число носителей тока и изменяет электронную зонную структуру вблизи уровня Ферми $E_{\rm F}$, в то время как изменение Z-компоненты в сплавах Co₂FeZ приводит лишь к электросопротивления, незначительному варьированию остаточного ВИД температурных зависимостей электросопротивления при этом остается неизменным.



Рисунок 1.6 – Температурные зависимости электросопротивления (a) Co₂YAl, (б) Co₂FeZ [15]. Стрелками показаны температуры Кюри

Таким образом, интересно проследить, будут ли наблюдаться подобные закономерности в поведении электронных свойств других сплавов Гейслера при изменении *Y*- и *Z*-компоненты, а именно Co₂*Y*Si и Co₂Mn*Z*, которые ранее систематически не изучались. Интересно, какие изменения будут происходить в поведении электронных, магнитных, оптических свойств, а также эффекта Холла при изменении числа валентных электронов.

В обзоре [32] приведены обобщающие данные по электросопротивлению для некоторых соединений Гейслера, как показано на рисунке 1.7. Температурные зависимости электросопротивления Fe₂TiAl и Co₂TiAl с остаточным сопротивлением 12 мкОм·см и 40 мкОм·см, соответственно, типичны для металлов. Для Co₂CrGa и Fe₂MnSi сопротивление также увеличивается с ростом температуры, однако, их остаточное сопротивление намного выше: для Co₂CrGa – 177 мкОм·см и для Fe₂MnSi – 154 мкОм·см. Зависимость $\rho(T)$ для Co₂MnAl и Fe₂MnAl выражена слабо, а для Co₂CrAl и Fe₂CrAl сопротивление демонстрирует полупроводниковый характер в том смысле, что $d\rho/dT < 0$ (см. рисунок 1.7).



Рисунок 1.7 – Температурные зависимости электросопротивления сплавов Гейслера на основе Со и Fe [32]

Низкотемпературное сопротивление большинства переходных металлов (не обязательно ферромагнитных) при температурах много меньше температуры Дебая θ_D (*T*<< θ_D) может быть описано формулой (1.10) [27]:

$$\rho = \rho_0 + AT^2 + BT^5 \tag{1.10}$$

Член $\sim T^5$ обусловлен электрон-фононным рассеянием, а член $\sim T^2$ доминирует при низких температурах и может быть связан с различными механизмами, в том числе с электрон-электронным рассеянием. Альтернативный механизм для T^2 зависимости удельного сопротивления в ферромагнитных металлах – рассеяние на спиновых волнах. Разделение электрон-электронного и электрон-магнонного рассеяния является трудной задачей. Так как T^2 -член сопоставим и в ферромагнитных, и в парамагнитных металлах, главная роль часто приписывается электрон-электронному механизму. Однако флуктуации плотности спина, которые появляются при конечных температурах даже в парамагнетиках, должны приводить к рассеянию носителей тока благодаря обменному взаимодействию. Это рассеяние можно рассматривать как усиление обменной части электронэлектронного рассеяния спиновыми флуктуациями [27].

Существование магнитных моментов в переходных элементах приводит к дополнительным факторам, которые влияют на поведение носителей тока во внешнем электрическом поле. Во-первых, из-за тепловых флуктуаций в системе магнитных моментов возникает новый механизм рассеяния вследствие *s* - *d* обменного взаимодействия. Во-вторых, электронный спектр магнитных кристаллов зависит от самопроизвольной намагниченности, сильно a следовательно, от температуры [27].

1.5.4 Гальваномагнитные явления

Магнитосопротивление (MC) определяется как изменение удельного сопротивления под действием магнитного поля *H*. Приложение магнитного поля

вызывает искривление траектории движения электронов. Это уменьшает длину свободного пробега электронов, что проявляется в положительном магнитосопротивлении, которое часто подчиняется квадратичной зависимости от напряженности магнитного поля. МС Δ*ρ*/*ρ* обычно определяется по формуле (1.11):

$$\Delta \rho / \rho = \Delta \rho_{xx} / \rho_{xx} (0) = (\rho_{xx}(H) - \rho_{xx}(0)) / \rho_{xx}(0)$$
(1.11)

Если в сильных магнитных полях МС изменяется по закону, близкому к линейному по полю, и при этом отрицательно, как показано на рисунке 1.8 (а), то такое поведение может быть обусловлено двухмагнонными процессами рассеяния. Такие процессы особенно хорошо проявляются в ПМФ при температурах, значительно меньших величины щели [27, 30, 32]. При низких температурах в слабых полях более важную роль играет рассеяние на электронных дефектах, поэтому наблюдается положительное МС [24]. На рисунке 1.8 (б) приведено МС для СБП Мп₂CoAl.



Рисунок 1.8 – Магнитосопротивление (а) ПМФ на основе Fe-V-Al [10], (б) СБП Mn₂CoAl [8, 9]

Эффект Холла заключается в том, что в магнитном поле под действием силы Лоренца искривляется траектория движения электронов. Искривление траекторий электронов проводимости приводит к изменению электросопротивления и к появлению добавочного, нечетного по полю холловского сопротивления [48, 53]. Измерения эффекта Холла позволяют получить информацию о типе, концентрации и подвижности носителей заряда. Коэффициент нормального эффекта Холла может быть отрицательным, в этом случае основными носителями заряда являются электроны, а если основными носителями тока являются дырки, то коэффициент нормального эффекта Холла будет положительным.

Сопротивление Холла ρ_{xy} измеряется при пропускании электрического тока через образец в форме тонкой пластины и приложении перпендикулярного ему магнитного поля (рисунок 1.9). Сопротивление Холла имеет линейную полевую зависимость от индукции магнитного поля (1.12):

$$\rho_{\rm xy} = R_0 B_{\rm z},\tag{1.12}$$

где R_0 – коэффициент Холла, $B_z = H_z + 4\pi M_z (1-N)$, N – размагничивающий фактор. При N = 1, $B_z = H_z$; H_z – напряженность магнитного поля вдоль оси z.



Рисунок 1.9 – Измерение эффекта Холла

На рисунке 1.10 (а) показана холловская проводимость СБП Mn₂CoAl. На рисунке 1.10 (б) приведено сопротивление Холла для ПМФ Co₂FeSi [24].

Для магнитных материалов, в особенности для ферромагнетиков ниже температуры Кюри, сопротивление Холла содержит дополнительный вклад, который не исчезает даже при H = 0. Этот член образуется в результате появления

внутреннего магнитного поля ферромагнетика и называется аномальным эффектом Холла (АЭХ), который определяется формулой (1.13) при размагничивающем факторе N = 1:

$$\rho_{\rm xy} = R_0 H_{\rm z} + 4\pi R_{\rm s} M_{\rm z}, \qquad (1.13)$$

где M_Z – намагниченность вдоль направления магнитного поля, а R_s называется аномальным коэффициентом Холла [53].



Рисунок 1.10 – (а) Холловская проводимость СБП Mn₂CoAl [9,10]; (б) сопротивление Холла ПМФ Co₂FeSi [24]

Аномальный эффект Холла вызван рассеянием носителей заряда на кристаллической решетке ферромагнитного материала (фононах и примесях) и магнонах при наличии спин-орбитального взаимодействия. Эти эффекты рассеяния приводят к тому, что поляризованные по спину носители заряда движутся в противоположных направлениях в соответствии с направлением спина, при этом перпендикулярно направлению тока.

Существует три основных механизма отклонения носителей заряда: собственный механизм, обусловленный спин-орбитальным взаимодействием

носителей с периодическим потенциалом ионов кристаллической решетки; асимметричное рассеяние на ионах примеси за счет спин-орбитального взаимодействия; механизм бокового смещения на ионах примеси без изменения направления движения. Асимметричное рассеяние обеспечивается линейным вкладом ρ в R_s , в то время как вклад механизма бокового смещения определяется как ρ^2 , при этом носители отклоняются в противоположные направления до и после рассеяния на примеси, которая создает поперечное внешнему электрическое поле [5, 10, 54].

1.5.5 Спин-поляризационные свойства

Спиновая поляризация (*P*) носителей заряда, как правило, определяется по формуле (1.14) [4]:

$$P = \frac{N_{\uparrow} - N_{\downarrow}}{N_{\uparrow} + N_{\downarrow}},\tag{1.14}$$

где $N\uparrow$, $N\downarrow$ – плотность электронных состояний на уровне Ферми, со спином «вверх» и «вниз», соответственно.

Спиновая поляризация обращается в нуль для парамагнетиков, однако, она имеет конечное значение в ферромагнитных или ферримагнитных материалах ниже температуры Кюри.

Типичный переходный металл имеет узкие *d*-зоны, которые могут быть полностью или частично поляризованы по спину из-за обменной энергии и широкие *s*-зоны с меньшей степенью спиновой поляризации из-за *s*-*d*-гибридизации. Если орбитальный характер на уровне Ферми в основном *d*-образный, то *P* будет высокой. С другой стороны, если орбитальный характер *s*-подобный или *s*-*d*-гибридный, то поляризация может быть низкой или высокой в зависимости от электронной структуры [53].
Существует несколько методов экспериментального измерения степени спиновой поляризации. Один из них – это андреевское отражение в точечном контакте (PCAR). Метод используется для оценки спиновой поляризации объемных и тонкопленочных материалов, является относительно простым, тщательная обработка поверхности образца не требуется. Андреевское отражение возникает при точечном контакте проводника и сверхпроводника при низких температурах. Электрон, налетающий на границу, отражается от поверхности сверхпроводника и превращается в дырку с той же энергией возбуждения. Так как заряд дырки противоположен заряду электрона, то при андреевском отражении, по закону сохранения заряда, заряд, равный удвоенной величине заряда электрона, переносится в сверхпроводник, образуя там куперовскую пару. Таким образом, ток через границу проводник-сверхпроводник примерно удваивается. С другой стороны, в ферромагнетике андреевское отражение несколько подавлено из-за разной плотности состояний носителей зарядов с направлением спинов «вверх» и «вниз». Когда ферромагнетик идеально поляризован по спину, нет электрона, который мог бы образовать куперовскую пару, поэтому проводимости в зоне запрещённых энергий сверхпроводника нет. Следовательно, проводимость изменяется в зависимости от спиновой поляризации материала. Для наблюдения андреевского отражения необходим точечный контакт в несколько десятков нанометров, меньше длины свободного пробега электронов, так как перенос должен быть баллистическим. Спиновая поляризация, оцененная с помощью метода PCAR, не совпадает с расчетом по плотности состояний по формуле (1.14) [55], поскольку на величину спиновой поляризации влияет наличие беспорядка, дефектов и изменение параметров решетки, когда E_F близок к краю запрещенной зоны. Так, спиновая поляризация объемного образца ПМФ Co₂MnSi, определенная с помощью метода PCAR составила всего 0,56. Расчет показывает, что Co₂MnGe является ПМФ с высокой $T_{\rm C} = 905$ К [25]. Однако измерения методом PCAR L_{21} упорядоченного Co₂MnGe показали, что спиновая поляризация составляет всего 59 %. Высокая степень спиновой поляризации в сплавах Гейслера в ПМФ и/или СБП-состояниях при комнатной температуре предсказана для идеальной

структуры *L*2₁, тогда как в реальных материалах могут наблюдаться небольшие разупорядочения, следовательно, степень спиновой поляризации уменьшается [55]. Этим же методом была определена спиновая поляризация и некоторых других сплавов Гейслера. Например, для сплавов Co₂MnSn, Co₂MnAl, Co₂MnGa и Co₂FeSi поляризация по спину составила 60 % [55].

Другой экспериментальный метод – ультрафиолетовая фотоэмиссионная спектроскопия со спиновым разрешением (SRUPS) – позволяет непосредственно измерить *P*. Первый фотоэмиссионный эксперимент по наблюдению спинполяризованных электронов был проведен на Gd Дж. Бушем и его коллегами в 1969 г. [56]. Однако помимо очень сложной экспериментальной установки, его энергетическое разрешение составляет сотни мэВ, что намного меньше необходимого энергетического разрешения (~1 мэВ). Хотя метод называется фотоэмиссией со спиновым разрешением, фотоны не испускаются, скорее, «фотоэмиссия» на самом деле означает индуцированную фотонами эмиссию электронов. Зависимость фотоэлектронного тока от энергии, направления и поляризации падающего электромагнитного излучения, а также от энергии и направления испускаемых электронов дает наиболее полную информацию об электронной структуре как «объемного» твердого тела, так и поверхности [12, 56].

1.6 Постановка задачи

Как уже указывалось ранее, в работах [12, 14, 15, 25, 28, 36, 37, 49-52] было показано, что изменение электронных и магнитных свойств сплавов Гейслера Co_2YZ при изменении Y- и Z-компоненты проявляется различным образом: в первом случае (при изменении Y-компоненты) наблюдаются кардинальные различия в величинах электросопротивления, эффекте Холла и намагниченности, а во втором (при изменении Z) данные изменения выражены более слабо. Несмотря на многочисленные экспериментальные и теоретические исследования электронной структуры, магнитных и электронных транспортных свойств сплавов Гейслера (как было

показано в разделах 1.2 - 1.5), до сих пор не было проведено комплексного исследования и сравнения поведения данных свойств сплавов Co₂*Y*Si и Co₂Mn*Z* (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe; *Z* = Al, Ga, Ge, Si, Sn) при изменении *Y*- и *Z*-компонент. Поэтому актуальной задачей является систематическое изучение электрических, магнитных, транспортных и оптических свойств сплавов Гейслера Co₂*Y*Si и Co₂Mn*Z* (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe; *Z* = Al, Ga, Ge, Si, Sn) для выяснения влияния на указанные характеристики изменения *Y*-компоненты, т.е. *3d*-металлов, и *Z*-компоненты (т.е. *p*элементов) и установления взаимосвязи между ними. Для выяснения того, как особенности электронного энергетического спектра вблизи уровня Ферми будут проявляться в электронных свойствах и магнитном состоянии сплавов Гейслера были поставлены следующие задачи:

1. Синтез соединений Гейслера $Co_2 YSi$, $Co_2 MnZ$ (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe; Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn), аттестация их кристаллической структуры.

2. Исследование электронных и магнитных свойств сплавов Co₂*Y*Si при изменении *Y*-компоненты, т.е. числа валентных 3*d*-электронов, и установление взаимосвязи между указанными характеристиками.

3. Изучение электронных транспортных, магнитных и оптических характеристик соединений Co₂MnZ при изменении Z-компоненты и установление взаимосвязи между указанными характеристиками.

2 Образцы и методика эксперимента

В настоящей главе описаны методики синтеза сплавов и приготовления образцов исследуемых соединений. Приводятся результаты элементного анализа полученных образцов и результаты рентгеноструктурного анализа. Описаны методики измерения электрических, магнитных и оптических свойств, а также эффекта Холла.

2.1 Синтез сплавов

Поликристаллические сплавы Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe) и Co₂Mn*Z* (*Z* = Al, Si, Ga, Ge, Sn) были приготовлены как в индукционной печи, так и методами дуговой плавки. Затем полученные слитки Co₂VSi, Co₂CrSi, Co₂FeSi отжигались при 1100 °C в течение 3 дней и подвергались закалке, сплавы Co₂TiSi, Co₂MnSi отжигались при 800 °C в течение 9 дней с последующим охлаждением до комнатной температуры, по аналогии с работами [57-59], сплавы Co₂Mn*Z* (*Z* = Al, Ga, Ge, Sn) отожжены при 800 К в течение 48 часов.

Из слитков электроискровым методом были вырезаны образцы. В результате электроискровой резки вблизи поверхности образцов образуется приповерхностный слой дефектов, который удалялся шлифовкой, химическим травлением и электрополировкой. Образцы для измерения электросопротивления имеют конечные размеры около (0,4 · 1,2 · 4,5) мм³ и намагниченности (кубик со стороной не более 2,5 мм).

2.2 Аттестация структуры

Для аттестации синтезированных материалов использованы растровый электронный микроскоп «QUANTA 200» с системой Pegasus для структурнотекстурного анализа EBSD и с энергодисперсионным спектрометром EDAX для элементного анализа. Выявлено, что отклонение от стехиометрического состава во всех образцах не превышает 6 %. В таблицах 2.1 – 2.2 приведены результаты анализа атомного содержания компонентов.

Сплав	Состав по данным	Co, %	<i>Y</i> , %	Si, %
	EDAX			
Co ₂ TiSi	Co _{1,98} Ti _{0,95} Si _{1,07}	49,50	23,75	26,75
Co ₂ VSi	Co _{1,98} V _{0,93} Si _{1,09}	49,50	23,25	27,25
Co ₂ CrSi	Co _{1,95} Cr _{0,99} Si _{1,06}	48,75	24,75	26,50
Co ₂ MnSi	Co _{1,9} Mn _{1,01} Si _{1,09}	47,50	25,25	27,25
Co ₂ FeSi	Co _{2,19} Fe _{0,65} Si _{1,16}	51,35	22,24	26,41

Таблица 2.1 – Состав сплавов Co_2YSi (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe)

Таблица 2.2 – Состав сплавов Co_2MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn)

Сплав	Состав по данным	Co, %	Mn, %	Z, %
	EDAX			
Co ₂ MnAl	Co _{1,99} Mn _{1,04} Al _{0,97}	49,75	26,00	24,25
Co ₂ MnSi	Co _{1,9} Mn _{1,01} Si _{1,09}	47,50	25,25	27,25
Co ₂ MnGa	Co _{1,95} Mn _{0,99} Ga _{1,06}	48,61	24,84	26,55
Co ₂ MnGe	Co _{2,18} Mn _{0,93} Ge _{0,89}	54,51	23,23	22,26
Co ₂ MnSn	Co _{2,05} Mn _{0,96} Sn _{0,99}	51,23	24,10	24,67

Структурный анализ проводился в Центре коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов» ИФМ УрО РАН. Рентгенографический анализ проводился на рентгеновских дифрактометрах «ДРОН-3», «ДРОН-6» и Empyrean («PANalytical») в фильтрованном СиКα-излучении в интервале углов 20°–120°.

В таблицах 2.3 – 2.4 представлены параметры решетки исследованных сплавов, определенные экспериментально и приведенные в литературе. Рентгенограммы на рисунках 2.1 – 2.2 показывают, что все исследованные сплавы

 $Co_2 YSi (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe)$ и $Co_2 MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn)$ имеют кубическую структуру $L2_1$, о чем свидетельствует наличие Брэгговских пиков сверхструктуры типа 111 и 200.

Сплав	Параметры решетки	Параметры решетки,		
	a _{exp} , Å	Å [60]		
Co ₂ TiSi	5,747	5,743		
Co ₂ VSi	5,650	5,657		
Co ₂ CrSi	5,640	5,647		
Co ₂ MnSi	5,660	5,645		
Co ₂ FeSi	5,640	5,640		

Таблица 2.3 – Параметры решетки сплавов $Co_2 YSi$ (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe)



Рисунок 2.1 – Рентгенограмма сплавов Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe) при комнатной температуре

Сплав	Параметры решетки	Параметры решетки,		
	a _{exp} , Å	Å [60]		
Co ₂ MnAl	5,765	5,749		
Co ₂ MnSi	5,660	5,645		
Co ₂ MnGa	5,760	5,767		
Co ₂ MnGe	5,760	5,749		
Co ₂ MnSn	6,000	5,999 [61]		

Таблица 2.4 – Параметры решетки сплавов Co_2MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn)



Рисунок 2.2 – Рентгенограмма сплавов Co_2MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn) при комнатной температуре

2.3 Измерение магнитных свойств

Измерение магнитных свойств проводилось в Центре коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов» ИФМ УрО РАН на магнитометрической установке MPMS-XL-5

(Quantum Design, США) (рисунок 2.3), предназначенной для измерения магнитных характеристик (намагниченности и магнитной восприимчивости) образцов с малыми величинами магнитного момента (слабомагнитных веществ или образцов с малым объемом). Кроме того, магнитные свойства измерялись в Атоминституте Технического университета Вены и Шанхайском электроэнергетическом университете на установке Quantum Design's MPMS XL-7 и универсальной установке для измерения физических свойств PPMS-9 (Quantum Design, США), соответственно.



Рисунок 2.3 – Магнитометрическая установка MPMS-XL-5

Магнитное поле было направлено вдоль одной из граней образца. Образцы представляли собой кубики размером ~ (2,5 · 2,5 · 2,5) мм³.

2.4 Методика измерения электросопротивления

Измерения электросопротивления проводились по общепринятой 4точеченой методике. Контакты из тонкой медной проволоки приваривались к образцам электроискровой сваркой. При измерении электросопротивления могут возникать паразитные эффекты. При протекании электрического тока в местах токовых контактов может возникнуть «микроразогрев». Поэтому желательно, чтобы сопротивление контактов было одинаковым, так как из-за различия температур контактов T_1 и T_2 возникает градиент температур ∇T , что приводит к появлению термоЭДС (рисунок 2.4).



Рисунок 2.4 – Схема измерения электросопротивления

Измеряемое напряжение $U_{\text{изм.}}$ можно записать как (2.1):

$$U_{\rm H3M} = U_{\rm PC} + U_{\rm Hap}, \tag{2.1}$$

где $U_{\rm PC}$ – напряжение, необходимое для расчета электросопротивления; $U_{\rm пар.}$ – паразитное напряжение.

Для исключения влияния паразитного напряжения U_{пар.}, измерения проводятся при противоположных направлениях тока +*I* и – *I*. Получается система уравнений (2.2):

$$\begin{cases} U_{\text{H3M.}}(+I) = U_{\text{3C}}(+I) + U_{\text{nap.}}(+I), \\ U_{\text{H3M.}}(-I) = -U_{\text{3C}}(-I) + U_{\text{nap.}}(-I). \end{cases}$$
(2.2)

Вычитая второе уравнение из первого, получаем формулу (2.3) для расчета напряжения *U*_{ЭC}:

$$U_{\rm C} = \frac{U_{\rm HSM.}(+I) + U_{\rm HSM.}(-I)}{2}.$$
 (2.3)

Формула (2.3) справедлива при измерении электросопротивления на постоянном токе. На рисунке 2.5 представлена схема установки для измерения электросопротивления.



Рисунок 2.5 – Схема установки для измерения электросопротивления

2.5 Методика измерения эффекта Холла

Измерения сопротивления Холла проводились в Центре коллективного «Испытательный пользования центр нанотехнологий И перспективных материалов» ИФМ УрО РАН на универсальной установке для измерения PPMS-9 физических свойств (Quantum Design, США), которая продемонстрирована на рисунке 2.6 (а). Предназначена для измерений физических свойств, таких как теплоемкость, сопротивление, эффект Холла, магнитный момент, восприимчивость. Также использовалась установка 17 Tesla measurement station (рисунок 2.6 (б)) в Атоминституте Технического университета Вены, сверхпроводящий магнит которой содержится в проточном газовом криостате, что

позволяет контролировать температуру образца в режиме газового охлаждения в широком диапазоне (примерно 5 К – 200 К).





(а) (б)
Рисунок 2.6 – (а) PPMS-9 (Quantum Design, США);
(б) Установка 17 Tesla measurement station

Кроме того, для измерения эффекта Холла использовалась установка фирмы «Oxford Instruments» (Великобритания), которая предназначена для исследования гальваномагнитных явлений в сильных магнитных полях, а также для измерений электросопротивления и эффекта Холла в объемных образцах и в гетероструктурах на постоянном и переменном токе. Основные характеристики: магнитное поле до 12 Т, интервал рабочих температур от 1,8 до 400 К.

2.5.1 Нормальный эффект Холла

Измерения эффекта Холла были выполнены по стандартной методике, которая подробно описана в работах [62, 63]. Полевые зависимости намагниченности и сопротивления Холла $\rho_{xy}(H)$ измерены при T = 4,2 К в магнитных полях до 100 кЭ. Исследованные образцы имели форму пластин с размерами ~ $(0.5 \cdot 1.5 \cdot 4.5)$ мм³. При этом вектор магнитного поля был направлен строго перпендикулярно плоскости пластин с точностью ± 2 градуса (или $\pm 2,5$ %), а электрический ток протекал вдоль наибольшей грани образца (см. рисунок 1.9). Для контроля асимметрии холловских контактов были проведены измерения по 5точечной схеме [64, 65], чтобы скомпенсировать вклад от поперечного сопротивления. Было обнаружено, что данные, полученные с помощью 5- и 4контактного методов хорошо совпадают, поэтому в дальнейшем использовалась 4-Для определения коэффициентов контактная методика. нормального И аномального эффектов Холла, в такой же поперечной геометрии осуществлялись измерения полевых зависимостей намагниченности M(H).

Для того, чтобы избавиться от паразитных эффектов и вкладов от магнитосопротивления в холловское сопротивление, измерения проводились с изменением направления тока, протекающего через образец, и направления магнитного поля. Расчет холловского напряжения проводился по следующей формуле (2.4):

$$U_{xy} = (U_1 (+I; +H) - U_2 (-I; +H) - U_3 (+I; -H) + U_4 (-I; -H))/4$$
(2.4)

Сопротивление Холла определялось по формуле (2.5):

$$\rho_{\rm xy} = d \cdot U_{\rm xy} / I \tag{2.5}$$

где U_{xy} – напряжение на холловских контактах, d – толщина образца, I – ток.

Коэффициент нормального эффекта Холла *R*₀ в однозонной модели определяется по формуле (2.6):

$$R_0 = \frac{1}{nec},\tag{2.6}$$

где *n* - число носителей тока, *c* – скорость света, *e* – заряд электрона. При учете двух типов носителей заряда, то есть электронов (*e*) и дырок (*h*), он определяется не только типом и числом (n_e и n_h) носителей, но и их подвижностью (μ_e и μ_h) (2.7):

$$R_{0} = (1/ec) \cdot \left(n_{h} \mu_{h}^{2} - n_{e} \mu_{e}^{2} \right) / \left(n_{h} \mu_{h} + n_{e} \mu_{e} \right)^{2}$$
(2.7)

Нормальный коэффициент R_0 зависит в основном от параметров электронной зонной структуры на уровне Ферми E_F . Поскольку в настоящее время отсутствуют надежные данные о поверхностях Ферми исследуемых в данной работе соединений, а также данные о концентрациях и подвижностях носителей заряда, принадлежащих различным листам их поверхностей Ферми, то в дальнейшем использована однозонная модель. Были определены тип носителей тока, преобладающих в том или ином соединении, оценены их концентрация по формуле (2.6) и подвижность по формуле (2.8):

$$\mu = \frac{R_0}{\rho_0} c, \tag{2.8}$$

где ρ_0 – электросопротивление образца без магнитного поля (остаточное сопротивление) [27].

2.5.2 Аномальный эффект Холла

Если при низких температурах сплавы находятся в ферромагнитном состоянии, то в них наблюдается и аномальный эффект Холла, для определения которого необходимо иметь данные о магнитных характеристиках системы. Для разделения нормальной и аномальной составляющих коэффициента Холла была построена зависимость по аналогии с [66]. Коэффициенты R_0 и R_s определяются методом экстраполяции на нулевое поле зависимости $\rho_{xy}/H(M/H)$ из области

парапроцесса. Поскольку для некоторых исследованных соединений не наблюдается насыщения или линейной зависимости $\rho_{xy}(H)$, была использована следующая формула (2.9):

$$\rho_{xy} / H = R_0 + 4\pi R_s^{/} \cdot M / H , \qquad (2.9)$$

где $R_{s}^{\prime} = R_{s} + (1-N) \cdot R_{0}$, а N – размагничивающий фактор. Размеры образцов для измерений эффекта Холла ~ $(0,5 \cdot 1,5 \cdot 4,5)$ мм³, чтобы размагничивающий фактор был около $N \approx 1$, т.е. имели соотношение 1:3:9. Тогда $R_{s}^{\prime} \approx R_{s}$.

2.6 Измерение оптических постоянных

Для измерения оптических постоянных: показателя преломления *n* и коэффициента поглощения *k* металлических образцов использовалась автоматизированная установка, схема которой показана на рисунке 2.7. Программное обеспечение позволяет сканировать спектр с постоянным шагом.

Зеркальные поверхности для оптических исследований были получены шлифованием образцов на микропорошках карбида бора разной дисперсности и полированием на окиси хрома. Измерения действительной $\varepsilon_1(\omega)$ и мнимой $\varepsilon_2(\omega)$ частей диэлектрической проницаемости выполнены эллипсометрическим методом Битти. Метод основан на анализе эллиптически поляризованного света, возникающего при отражении линейно поляризованного света от поверхности металла. Точность измерений составляла (2–5) % во всех областях спектра.

Обозначения на рисунке 2.7: 1 – источник излучения; 2, 8, 13 – плоские поворотные зеркала; 3, 9, 14 – сферические поворотные зеркала; 4 – светофильтр; 5 – модулятор; 6 – входная щель монохроматора МДР-12; 7 – выходная щель МДР-12; 10, 12 – поляризаторы; 11 – образец в центре столика гониометра; 15 – фотоприемное устройство.



Рисунок 2.7 – Схема установки для измерения оптических постоянных металлов [67]

3 Электронные и магнитные свойства сплавов Гейслера Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe)

Поскольку кинетические свойства металлов в основном определяются плотностью электронных состояний N на уровне Ферми E_F , то можно ожидать, что кинетические коэффициенты (электросопротивление, эффект Холла и др.) в этих соединениях будут меняться при изменении числа валентных 3*d*-электронов. При этом возникает вопрос о поведении других электронных, а также магнитных характеристик в этих сплавах.

В настоящей главе приводятся результаты измерения электросопротивления, намагниченности, эффекта Холла и оптических свойств сплавов Co_2YSi (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe). Обнаружено, что поведение остаточного электросопротивления, спонтанной намагниченности, коэффициентов нормального и аномального эффекта Холла, оптической проводимости на инфракрасных частотах и степени спиновой поляризации¹ носителей заряда в зависимости от числа валентных электронов имеют одинаковый характер.

3.1 Температурные зависимости электросопротивления

На рисунке 3.1 (а) представлены температурные зависимости электросопротивления сплавов Co₂*Y*Si (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe). Видно, что все соединения обладают металлическим типом проводимости, т.е. сопротивление возрастает с температурой. Однако при этом для разных сплавов наблюдается существенное различие в величине остаточного сопротивления и температурном коэффициенте сопротивления (ТКС) (рисунок 3.1 (а) и таблица 3.1).

В таблице 3.1 приведены значения остаточного сопротивления ρ_0 исследуемых сплавов. Видно, что значения остаточного сопротивления исследованных сплавов существенно изменяются от низких значений для сплавов Co₂FeSi и

¹Приводятся литературные данные.

Со₂MnSi (10 и 16 мкОм·см) до высоких значений ρ_0 для сплавов Co₂VSi и Co₂CrSi (294 и 324 мкОм·см), т.е. значения ρ_0 различаются на порядок. Кроме того, именно для этих «высокоомных» сплавов Co₂VSi и Co₂CrSi с большими значениями ρ_0 наблюдается ослабление зависимости $\rho(T)$ при высоких температурах.



Рисунок 3.1 – (а) Температурные зависимости электросопротивления; (б) температурные зависимости относительного электросопротивления сплавов Co₂YSi

Таблица 3.1 – Число валентных электронов z, остаточное сопротивление ρ_0 , коэффициенты A, B сплавов Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe)

Сплав	Z	<i>р</i> ₀, мкОм∙ см	А, 10 ⁻² мкОм·см·К ⁻¹	В, 10 ⁻³ мкОм·см·К ⁻²
Co ₂ TiSi	26	155	$-8,1 \pm 0,1$	$2,\!40\pm0,\!02$
Co ₂ VSi	27	294	7,0 ± 0,3	$0,\!92\pm0,\!04$
Co ₂ CrSi	28	324	$16,8\pm0,5$	0,71 ± 0,08
Co ₂ MnSi	29	16	$-1,3 \pm 0,1$	0,36 ± 0,02
Co ₂ FeSi	30	10	$-0,40 \pm 0,06$	0,21 ± 0,01

Поскольку масштаб рисунка 3.1 (а) не позволяет провести сравнение вида температурных зависимостей, построен рисунок 3.1 (б), где по оси ординат отложена величина относительного сопротивления ($\rho - \rho_0$)/ ρ_0 .

Стоит отметить, что температурная зависимость относительного сопротивления от температуры становится линейной при высоких температурах (Т > 100 К) для Co₂MnSi, Co₂FeSi (рисунок 3.1 (б)), что означает «сильную» зависимость. Ослабление металлическую температурной зависимости сопротивления температурах наблюдаться при высоких может В «высокорезистивных» металлах и часто свидетельствует о наличии параллельных каналов проводимости [68]. Проводимость можно рассматривать как сумму проводимостей двух параллельно соединенных проводников. Один из них – это подсистема носителей заряда со спином «вверх», обладающая типичной «металлической» проводимостью, а другой – это подсистема со спином «вниз», имеющая полупроводниковый вид зависимости. Общая проводимость определяется суммой этих вкладов [28].

При низких температурах ($T \ll \Theta_D$, T_C) фононный вклад в сопротивление можно описать следующим простым выражением: $\rho_{ph}(T) = cT^5$. T^5 – сильная зависимость, которая не наблюдается. Тогда сумма оставшихся низкотемпературных вкладов в электросопротивление ферромагнитного металла может быть выражена формулой (3.1) [48, 53, 69]:

$$\rho(T) = \rho_0 + \mathbf{A}T + \mathbf{B}T^2 \tag{3.1}$$

Как показано на рисунке 3.2, зависимость вида (3.1), действительно, наблюдается для всех исследованных сплавов при низких температурах (15 K ≤ T ≤ 50 K). Точками обозначены экспериментальные данные, а сплошными линиями – результат подгонки, согласно формуле (3.1).

Данный тип низкотемпературной зависимости электросопротивления характерен для ферромагнитных сплавов [53], поскольку процессы рассеяния электронов проводимости на магнитных неоднородностях становятся существенными в низкотемпературной области. Взаимодействие носителей тока со спиновой магнитной подсистемой за счет *s* – *d* обменной связи или за счет спин-орбитального взаимодействия приводит к дополнительным линейным и квадратичным вкладам. Определенные таким образом коэффициенты А и В представлены в таблице 3.1.

Формулу (3.1) часто применяют для описания температурных зависимостей электросопротивления при низких температурах. При этом отрицательные значения коэффициента А возникают в случае, когда в энергетическом спектре металлов имеются «щелевые» особенности, т.е. линейный по температуре член – это первый член в разложении экспоненты.



Рисунок 3.2 – Температурная зависимость удельного электросопротивления ho(T) при 15 К $\leq T \leq$ 50 К

Коэффициент В в формуле (3.1), как правило, определяется электронэлектронным рассеянием, вклад которого становится значительным в области низких температур. Квадратичный вид температурной зависимости электросопротивления также может возникать по причине электрон-магнонного рассеяния [53, 69]. Для сплавов Co₂TiSi, Co₂MnSi, Co₂FeSi результат подгонки дает отрицательный знак коэффициента A (таблица 3.1). Эксперимент показывает, что при очень низких температурах (T < 15 K) сопротивление недостаточно хорошо описывается формулой (3.1). Электрон-магнонное рассеяние не реализуется, и температурная зависимость электросопротивления отклоняется от квадратичного закона, согласно формуле (1.8).

Оценка длины свободного пробега носителя заряда согласно критерию Иоффе-Регеля [68] показывает, что соединения Co₂VSi и Co₂CrSi находятся близко к порогу локализации, поэтому величина электросопротивления данных материалов ~ 300 мкОм·см. Согласно [68], сопротивление металлов не может превышать значение 300 мкОм·см. Стоит отметить, что Co₂CrSi имеет $\rho_0 = 324$ мкОм·см. Согласно правилу Муиджи (Mooij rule) [68, 70], в металлических системах со статическим беспорядком, т.е. с удельным сопротивлением $\rho > (150-200)$ мкОм·см, обычно наблюдается отрицательный ТКС. Однако в соединениях Co₂VSi и Co₂CrSi данное правило не выполняется, ТКС положительный, хотя и небольшой.

Дополнительную информацию об электронных и магнитных характеристиках исследуемых сплавов можно получить из измерений их магнитных свойств и эффекта Холла.

3.2 Намагниченность и эффект Холла

На рисунке 3.3 приведены полевые зависимости намагниченности M(H) сплавов Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe) при *T* = 4,2 K. Видно, что намагниченность *M* сплавов Co₂TiSi, Co₂MnSi Co₂FeSi выходит на насыщение в полях, превышающих 10 кЭ. Исключением являются Co_2VSi и Co_2CrSi . По полученным данным (рисунок 3.3) определены значения спонтанной намагниченности $M_{s exp}$, см. таблицу 3.2.



Рисунок 3.3 – Полевые зависимости намагниченности сплавов $Co_2 YSi$ при T = 4,2 К

Значения $M_{s exp}$ значительно различаются для разных сплавов. Также определена восприимчивость парапроцесса χ (см. таблицу 3.2) для всех исследованных сплавов. Восприимчивость парапроцесса нулевая для сплавов Co₂TiSi и Co₂MnSi, для остальных сплавов восприимчивость отлична от нуля. Также в таблице 3.2 представлены значения температуры Кюри T_C для всех исследованных сплавов, согласно работе [36].

На рисунке 3.4 приведены полевые зависимости сопротивления Холла $\rho_{xy}(H)$ при T = 4,2 К. Видно, что сопротивление Холла четырех исследованных составов ведет себя похожим образом, кроме Co₂MnSi.

Таблица 3.2 – Спонтанная намагниченность $M_{s exp}$, восприимчивость парапроцесса χ , степень спиновой поляризации носителей заряда P и температуры Кюри T_c сплавов Co₂YSi (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe)

Сплав	$M_{ m s\ exp}$,	x 10 ⁻⁴	Р,	<i>Т</i> _с , К
	μ _В /ф.е.	χ, 10	%	[36]
Co ₂ TiSi	1,69	< 10 ⁻⁵	24 [36]	385
Co ₂ VSi	0,21	$1,30 \pm 0,02$	35 [36]	566
Co ₂ CrSi	0,04	$1,90 \pm 0,04$	80 [36]	747
Co ₂ MnSi	4,76	< 10 ⁻⁵	93 [12]	985
Co ₂ FeSi	5,80	$1,30 \pm 0,05$	57 [14]	1100



Рисунок 3.4 – Полевые зависимости сопротивления Холла сплавов Co₂*Y*Si при T = 4,2 K

Вид сопротивления Холла для Co₂MnSi говорит о том, что основными носителями заряда в данном материале являются электроны. Что касается остальных образцов, то определение типа основных носителей заряда требует обработки данных по уравнению (2.9).

Используя полученные данные, согласно формуле (2.9), построены зависимости $\rho_{xy}/H = f(M/H)$, показанные на рисунке 3.5. В пределе сильных полей (H > 10 кЭ) соотношение (2.9) действительно справедливо для всех исследованных сплавов. Анализ полученных данных позволил определить значения коэффициентов нормального R_0 и аномального R_s эффекта Холла, см. таблицу 3.3. Для сплавов Co₂VSi и Co₂CrSi коэффициент нормального эффекта Холла R_0 также отрицателен, т.е. основными носителями заряда являются электроны, как и в случае Co₂MnSi Как видно из таблицы 3.3, в случае Co₂VSi коэффициент нормального эффекта Холла определяется с большой погрешностью.

Таблица 3.3 – Тип основных носителей заряда, нормальный R_0 и аномальный R_s коэффициенты Холла, концентрация носителей заряда *n*, их подвижность μ сплавов Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe)

Сплав	Тип носителя	<i>R₀</i> , 10 ⁻⁴ см ³ /Кл	<i>R</i> _s , 10 ⁻² см ³ /Кл	<i>n</i> , 10 ²² см ⁻³	<i>μ</i> , см²/(В·с)
Co ₂ TiSi	дырки	4,9 ± 0,3	3,80 ± 0,04	1,3	3,2
Co ₂ VSi	электроны	$-0,9 \pm 0,7$	29,5 ± 0,6	7,0	0,4
Co ₂ CrSi	электроны	$-2,6 \pm 0,4$	33 ± 1	2,4	1,0
Co ₂ MnSi	электроны	$-1,5 \pm 0,1$	$0,040 \pm 0,001$	4,0	9,7
Co ₂ FeSi	дырки	$0,74 \pm 0,04$	$0,025 \pm 0,001$	8,4	7,4

Используя однозонную модель, проведена оценка концентрации n и подвижности носителей заряда μ (таблица 3.3) в соответствии с формулами (2.6) и (2.8). Видно, что в случае Co₂VSi оценка концентрации носителей заряда завышена, поскольку коэффициент R_0 имеет малую величину. Как будет показано далее в разделе 3.3, оценка эффективной концентрации носителей заряда, действительно,

дает величину на порядок меньше. Можно сделать вывод, что в данном соединении имеются разные типы носителей, и оно обладает сложным характером поверхности Ферми. Электронный и дырочный вклад в значительной степени компенсируют друг друга. Co₂FeSi также имеет малое значение R_0 . В сплавах Co₂YSi при изменении числа валентных электронов в ряду Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe при z = 27 и 30, т.е. для V и Fe, соответственно, происходит смена основного типа носителей заряда. Стоит отметить, что соединения Co₂MnSi и Co₂FeSi имеют высокую концентрацию и подвижность носителей заряда, что согласуется с данными по электросопротивлению (см. раздел 3.1) и говорит о сильных металлических свойствах.



Рисунок 3.5 – Зависимость $\rho_{xy}/H = f(M/H)$ для сплавов Co₂*Y*Si

Видно, что коэффициент R_s превышает R_0 на два-три порядка, что характерно для ферромагнитных сплавов. Стоит отметить, что во всех случаях, независимо от типа носителей заряда, коэффициенты аномального эффекта Холла являются положительными.

Следует отметить, что измерения проводились на поликристаллических образцах, поэтому оценки концентрации n и подвижности μ носителей заряда носят только качественный характер. Однако оказалось, что такие качественные оценки вполне согласуются с другими параметрами, полученными из эксперимента, как будет показано в разделе 3.4. Кроме того, использовалось однозонное приближение, хотя на самом деле исследуемые сплавы имеют гораздо более сложную электронную структуру. В этом случае поверхность Ферми каждого из исследованных соединений состоит из нескольких листов как электронного, так и дырочного типа. Для точного определения знака, концентрации и подвижности носителей тока, их вклада в электронные транспортные свойства необходимы данные о деталях их поверхностей Ферми, которые в настоящее время отсутствуют. Поэтому для оценки концентрации и подвижности носителей заряда использовалась однозонная модель, которая дает разумные результаты за исключением Co₂VSi, когда концентрации электронов и дырок близки друг к другу.

3.3 Оптические свойства

На рисунке 3.6 приведен график дисперсии действительной $\varepsilon_1(\omega)$ и мнимой $\varepsilon_2(\omega)$ частей диэлектрической проницаемости исследованных сплавов. В инфракрасной области спектра наблюдается монотонный рост $|\varepsilon_1(\omega)|$ и $\varepsilon_2(\omega)$ для всех сплавов при увеличении длины волны падающего света, что указывает на основную роль механизма внутризонного поглощения света [45] при формировании оптических свойств в данной области.

В сплавах Co₂TiSi, Co₂VSi, Co₂CrSi рост $|\varepsilon_1(\omega)|$ и $\varepsilon_2(\omega)$ происходит значительно медленнее, чем в Co₂FeSi, Co₂MnSi. В разделах 3.1 – 3.2 показано, что

Co₂TiSi, Co₂VSi и Co₂CrSi обладают высоким остаточным сопротивлением, невысокими значениями концентрации и подвижности носителей заряда, что говорит о «плохих» металлических свойствах, а Co₂FeSi и Co₂MnSi ведут себя как «хорошие» металлы, обладая низким остаточным сопротивлением, высокой концентрацией и подвижностью носителей заряда.



Рисунок 3.6 – Дисперсия реальной ε₁(ω) (ниже нуля по оси ординат) и мнимой ε₂(ω) (выше нуля на оси ординат) частей диэлектрической постоянной

Отрицательные значения действительной части диэлектрической проницаемости свидетельствуют о наличии свободных носителей в каждом сплаве, однако, их концентрация существенно отличается. Стоит отметить особенности поведения $\varepsilon_1(\omega)$ и $\varepsilon_2(\omega)$ сплава Co₂CrSi, для которого зависимость $\varepsilon_1(\omega)$ совпадет с зависимостями для «плохих» металлов Co₂TiSi, Co₂VSi, а зависимость $\varepsilon_2(\omega)$ близка к зависимостям «хороших» металлов Co₂FeSi, Co₂MnSi.

Анализ зависимости $1/\epsilon_1 = f(\omega^2)$, согласно формуле (1.4) дает оценку квадрата плазменной частоты электронов проводимости Ω^2 : ~22·10³⁰ c⁻² для Co₂FeSi и Co₂MnSi, ~2,6·10³⁰ c⁻² для Co₂TiSi, Co₂VSi, Co₂CrSi, т.е. значения отличаются практически на порядок. Квадрат плазменной частоты связан с плотностью состояний на уровне Ферми и пропорционален скорости электронов на поверхности Ферми.

Из соотношения $N_{3\phi\phi} = \Omega^2 \cdot m/(4\pi \cdot e^2)$ (*е* и *m* – заряд и масса свободного электрона, соответственно) были получены оценки эффективной концентрации носителей заряда: $N_{3\phi\phi} \sim 10^{22}$ см⁻³ для Co₂FeSi, Co₂MnSi – значение, характерное для металлических соединений; для Co₂TiSi, Co₂VSi, Co₂CrSi $N_{3\phi\phi} \sim 10^{21}$ см⁻³, что на 1-2 порядка ниже по сравнению с нормальными металлами, и несколько отличается от концентрации носителей заряда, полученной с помощью измерений эффекта Холла и приведенной в таблице 3.3.

Отражательная способность R также является характеристикой, указывающей на «металличность» вещества. Для «хороших» металлов в инфракрасной области она близка к единице, с началом интенсивного межзонного поглощения резко уменьшается. Самая высокая отражательная способность в инфракрасной области, достигающая R~0,9, и следовательно, наилучшие металлические свойства, наблюдаются в сплавах Co₂FeSi и Co₂MnSi, как видно на рисунке 3.7, что совпадает с дисперсией $\varepsilon_1(\omega)$ и $\varepsilon_2(\omega)$ (рисунок 3.6). В сплавах Co₂TiSi и Co₂VSi отражательная способность достигает всего лишь R~0,78. Полученные результаты согласуются с данными по остаточному сопротивлению (см. таблицу 3.1). Мнимая часть диэлектрической проницаемости $\varepsilon_2(\omega)$ позволяет установить связь между оптическими данными и структурой энергетических зон. Оптическая проводимость рассчитывалась по формуле (1.3).



Рисунок 3.7 – Отражательная способность сплавов Co₂YSi

На рисунке 3.8 приведена оптическая проводимость σ исследованных сплавов в области энергий фотона E=(0,15-5,0) эВ. Видно, что кривые оптической проводимости исследованных сплавов делятся на 2 группы по характеру частотной зависимости. Сплавы Co₂FeSi и Co₂MnSi имеют зависимость σ , типичную для металлов, т.е. рост поглощения (друдевский подъем) происходит в инфракрасной области, а основная полоса поглощения находится в видимой и ультрафиолетовой области спектра. Характерной особенностью спектра оптического поглощения металлических систем является наличие минимума на кривой, соответствующего границе между областью внутризонного и межзонного поглощения. Для Co₂FeSi можно выделить минимум при энергии 0,65 эВ и основную полосу поглощения с максимумом при 1,4 эВ. Для Co₂MnSi на кривой имеется минимум при энергии

0,59 эВ; основная полоса поглощения имеет широкий максимум вблизи 1,7 эВ. Разница проводимости Co₂FeSi в минимуме и максимуме составляет $14 \cdot 10^{14}$ c⁻¹, а для Co₂MnSi – $26 \cdot 10^{14}$ c⁻¹, т.е. граница для Co₂MnSi является более резкой, чем для Co₂FeSi. Статическая проводимость при комнатной температуре, полученная из измерений электросопротивления, равна $275 \cdot 10^{14}$ c⁻¹ для Co₂MnSi; $350 \cdot 10^{14}$ c⁻¹ для Co₂FeSi и $25, 6 \cdot 10^{14}$ c⁻¹ для Co₂CrSi.



Рисунок 3.8 – Дисперсия оптической проводимости

Для Co₂CrSi не наблюдается выраженного минимума, отсутствует выраженная основная полоса поглощения. Практически по всей исследованной области наблюдается рост оптической проводимости с уменьшением энергии падающей световой волны и пики межзонного поглощения на его фоне.

Принципиально другой характер частотной зависимости оптической проводимости имеют сплавы Co₂TiSi, Co₂VSi. Основной особенностью оптических спектров этих сплавов является отсутствие друдевского подъема вплоть до длинноволновой границы исследованного интервала. Статическая проводимость при комнатной температуре, полученная из измерений электросопротивления,

равна $39,5 \cdot 10^{14}$ с⁻¹ для Co₂TiSi и $28,7 \cdot 10^{14}$ с⁻¹ для Co₂VSi. Очевидно, что в исследованной области не представляется возможным выйти на друдевский подъем. Полоса межзонного поглощения для Co₂VSi имеет центр при E~1.4 эВ и наибольшую среди всех исследованных сплавов интенсивность. Для Co₂TiSi полоса поглощения имеет наименьшую интенсивность с максимумом при E~1,9 эВ. На кривой можно заметить небольшой изгиб вблизи 0,54 эВ. Данные сплавы характеризуются как «плохие металлы».

Оценки частоты релаксации, которая характеризует различные механизмы поглощения световой волны, дают значения $\gamma = 1,8 \cdot 10^{-1}$ с⁻¹ для сплава Co₂FeSi и $\gamma = 2 \cdot 10^{-14}$ с⁻¹ для сплава Co₂MnSi. Для остальных сплавов не представляется возможность определить γ , поскольку отсутствуют участки, где доминирует внутризонное поглощение и нет вклада от межзонного поглощения.

Для Co₂TiSi результаты вычисления электронной структуры (рисунок 3.9), дают довольно высокую плотность состояний на уровне Ферми. В сплавах Co₂VSi и Co₂CrSi низкие значения магнитного момента сопровождаются псевдощелевым характером плотности состояний вблизи энергии Ферми в обеих проекциях спина с нулевой для Co₂CrSi и почти нулевой поляризацией для Co₂VSi. Данное поведение хорошо согласуется с отсутствием друдевского подъема в этих двух сплавах и высокими значениями ρ_0 .

3.4 Взаимосвязь электронных и магнитных свойств

Выяснение роли особенностей плотности состояний на уровне Ферми в формировании электронных свойств и магнитного состояния исследуемых соединений Гейслера Co₂*Y*Si при изменении *Y*-компоненты, представляет собой интересную и актуальную задачу. На рисунке 3.9 [A1] продемонстрирована плотность электронных состояний *N*, рассчитанная на основе полученных в данной работе экспериментальных данных о структуре и параметрах решетки. Уровень Ферми расположен в нуле энергий и показан вертикальной пунктирной линией.



Рисунок 3.9 – Плотность электронных состояний *N*(*E*) для обеих проекций спина сплавов Гейслера Co₂*Y*Si [A1]

Расчеты электронной структуры сплавов Гейслера Co₂*Y*Si выполнены в приближении локальной электронной спиновой плотности в рамках пакета программ TB-LMTO-ASA. В базис линеаризованных маффин-тин орбиталей были включены 4*s*-, 4*p*-, 3*d*-состояния переходных 3*d* металлов, а также 3*s*-, 3*p*- и 3*d*-состояния алюминия или кремния. Интегрирование в обратном пространстве осуществлялось по сетке k-точек с полным числом $12 \times 12 \times 12$. Расчеты проведены для структуры *L*2₁ типа (пространственная группа симметрии № 225) для экспериментальных величин постоянных решетки. Данные опубликованы в [A1].

В таблице 3.4 [A1] приведены магнитные моменты, плотности электронных состояний и степень спиновой поляризации рассматриваемых соединений Co₂*Y*Si. Видно, что в сплавах Co₂*Y*Si полный магнитный момент M_{total} различается значительно от 0 до 5 μ_{B}/ϕ .е. при изменении компоненты *Y*.

Состав	$M_{ m total}$,	$M_{2\mathrm{Co}},$	$M_{\mathrm{Y}},$	$M_{\rm Si}$,	<i>N, состояния /</i> (эВ ∙			Степень
	$\mu_B/\varphi.e.$	$\mu_{\rm B}$	$\mu_{\rm B}$	μ_{B}	ячейка)		спиновой	
					вверх	вниз	общее	поляризации
Co ₂ TiSi	1,60	1,70	-0,10	0,00	4,00	0,80	4,80	0,66
Co ₂ VSi	0,79	0,70	0,10	-0,01	0,60	0,90	1,50	0,20
Co ₂ CrSi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00
Co ₂ MnSi	5,00	2,04	3,05	-0,09	2,02	0,00	2,02	1,00
Co ₂ FeSi	4,97	2,30	2,70	-0,03	0,90	3,00	3,90	0,54
Co ₂ MnSn	0,97	3,30	-0,14	5,10	1,49	0,29	1,78	0,67

Таблица 3.4 – Магнитный момент, плотность электронных состояний на уровне Ферми и степень спиновой поляризации Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe) [A1]

Сравнивая полученные экспериментальные результаты с расчетами электронной зонной структуры, см. рисунок 3.9, можно отметить следующие особенности. Вычисленные полные магнитные моменты *M*_{total} (таблица 3.4) сплавов Co2TiSi, Co2MnSi и Co2FeSi обладают большими значениями по сравнению с Co₂CrSi и Co₂VSi и соответствуют экспериментальному магнитному моменту *M*_{s exp}. Большие магнитные моменты Fe и Mn соответствуют сильной поляризации 3d состояний. Полный магнитный момент сплава Co₂VSi очень мал, а в сплаве Co₂CrSi он близок к нулю, что также соответствует экспериментальным данным. Стоит отметить, что причиной небольшого различия между результатами особенности эксперимента расчета магнитных моментов могут быть И поликристаллических образцов [42, 71], а также методы расчета.

Вывод о том, что соединения Co₂MnSi и Co₂FeSi являются ПМФ был сделан на основе определения степени спиновой поляризации Co₂FeSi методом андреевского отражения в точечном контакте в работе [14] и ультрафиолетовой фотоэмиссионной спектроскопии со спиновым разрешением для Co₂MnSi [12]. Полученные в настоящей работе экспериментальные результаты (разделы 3.1-3.3), а также данные о плотности состояний подтверждают, что соединение Co₂MnSi находится в ПМФ состоянии с высоким значением полного магнитного момента и «металлической» формой кривой оптической проводимости. Ситуация с типичной для металлов зависимостью оптической проводимости и электросопротивления обнаружена в Co₂FeSi, но плотность состояний не нулевая для обоих направлений спина. По этой причине спиновая поляризация Co₂FeSi меньше, чем Co₂MnSi. Уровень Ферми в Co₂FeSi расположен вблизи края энергетической щели. В подсистеме со спином «вверх» (\uparrow) *d* состояния Со и Mn (Fe) формируют общую *d* зону, которая расположена ниже уровня Ферми. Плотность состояний *p*-электронов ниже *E*_F и распределена равномерно во всем диапазоне энергий. Переходы между гибридизированными состояниями (*p*, *d*) Со, (Mn, Fe), Si в полосе со спином «вверх» дают небольшой вклад в оптическую проводимость. Главный вклад в результирующую кривую $\sigma(\omega)$ дают электронные переходы в зоне с направлениями спина «вниз», которые могут проявляться, когда энергия падающей волны больше, чем ширина энергетической щели.

На рисунке 3.10 приведена зависимость плотности электронных состояний N на уровне Ферми в зависимости от числа валентных электронов для сплавов Co₂*Y*Si, согласно расчетным данным таблицы 3.4. Каждой точке на графиках соответствует конкретное соединение Co₂*Y*Si, но для удобства указаны лишь названия *Y*-элемента каждого из сплавов.

Электронные свойства металлов в основном определяются плотностью электронных состояний N вблизи уровня Ферми E_F и подвижностью электронов, поэтому при изменении числа валентных 3d-электронов предполагается систематическое изменение поведения электронных транспортных, оптических, а также магнитных характеристик в этих сплавах, взаимосвязанное с изменением плотности электронных состояний N. Чтобы проверить данное предположение, были построены зависимости остаточного электросопротивления, спонтанной намагниченности, коэффициентов нормального и аномального эффекта Холла, концентрации и подвижности носителей заряда, а также коэффициентов спиновой поляризации, взятых из литературных данных [12, 14, 36] в зависимости от числа валентных электронов z (рисунки 3.11 – 3.15).



Рисунок 3.10 – Плотность электронных состояний N(*E*_F) для сплавов Co₂*Y*Si в зависимости от числа валентных электронов *z*

Стоит отметить следующие особенности. Во-первых, как видно на рисунке 3.11 зависимость нормального коэффициента Холла R_0 от числа валентных электронов ведет себя подобно плотности электронных состояний N на уровне Ферми (рисунок 3.10).

Во-вторых, как видно на рисунке 3.12, зависимости остаточного сопротивления и коэффициентов аномального эффекта Холла R_s от числа валентных электронов подобны друг другу. Остаточное сопротивление ρ_0 сильно зависит от процессов рассеяния, поэтому вид зависимости несколько отличается от поведения зависимости плотности электронных состояний. Аномальный коэффициент Холла R_s , кроме спин-орбитального взаимодействия, может определяться механизмами рассеяния, поэтому его зависимость от числа валентных электронов аналогична зависимости остаточного сопротивления.

Стоит также отметить связь рисунков 3.12 и 3.10, 3.11. В случае z = 28 (соединение Co₂CrSi) для плотности состояний и нормального коэффициента Холла наблюдается минимум, при этом для остаточного сопротивления и аномального коэффициента Холла наблюдается максимум.



z, число валентных электронов





Рисунок 3.12 – Остаточное сопротивление *ρ*₀ и коэффициенты аномального эффекта Холла *R*_s в зависимости от числа валентных электронов

Как уже обсуждалось ранее, однозонная модель несправедлива в случае Co₂VSi, оценка концентрации носителей заряда получается завышенной. По этой причине на рисунке 3.13 значения концентрации и подвижности носителей заряда не приводятся. В целом видно, что концентрация и подвижность носителей заряда

определенным образом коррелируют друг с другом и с данными, приведенными на рисунках 3.10 – 3.15.



Рисунок 3.13 – Концентрация *n* и подвижность *µ* носителей заряда в зависимости от числа валентных электронов

В-третьих, на рисунке 3.14 показана оптическая проводимость 6 при энергии E = 0,155 эВ, измеренная при комнатной температуре, и проводимость $1/\rho_{RT}$ при T = 300 К в зависимости от числа валентных электронов. Видно, что поведение этих зависимостей коррелирует между собой. Исключением является Co₂CrSi, сопротивление которого велико (см. рисунок 3.1 (а)), а оптические свойства занимают «промежуточное» положение среди других исследованных соединений (см. раздел. 3.3).

В-четвертых, на рисунке 3.15 построена спонтанная намагниченность $M_{s exp}$, коэффициенты аномального эффекта Холла R_s и степень спиновой поляризации P в зависимости от числа валентных электронов (см. данные таблиц 3.2 и 3.3).


Рисунок 3.14 – Проводимость 1/ ρ_{RT} при комнатной температуре и оптическая проводимость б в зависимости от числа валентных электронов

Видно, что с изменением числа валентных электронов спонтанная намагниченность имеет минимум при z = 28, тогда как коэффициент аномального эффекта Холла при данном числе валентных электронов имеет максимум. Из литературных данных были взяты степени спиновой поляризации *P* носителей заряда исследованных соединений [12, 14, 36]. Методы определения спиновой поляризации различны: Co₂TiSi, Co₂VSi, Co₂CrSi – расчеты на основе теории функционала плотности [36], Co₂FeSi – андреевское отражение в точечном контакте (PCAR) [14], Co₂MnSi – ультрафиолетовая фотоэмиссионная спектроскопия со спиновым разрешением (SRUPS) [12]. Поведение зависимости степени спиновой поляризации от числа валентных электронов имеет близкий характер к поведению таковой зависимости спонтанной намагниченности.

Аномальный коэффициент Холла R_s и остаточное сопротивление ρ_0 имеют минимум вблизи z = 29, 30, то есть для Co₂MnSi и Co₂FeSi, в то время как для коэффициента нормального эффекта Холла R_0 значения возрастают, а для намагниченности $M_{s exp}$ при этом наблюдается максимум. По-видимому, это может

быть связано с тем, что в данных соединениях преимущественно имеются «металлические» носители тока co спином «вверх», обеспечивающие «металлический» проводимости, соответственно, тип низкое остаточное сопротивление и большой магнитный момент, что, в конечном итоге, и может приводить к высокой поляризации по спину носителей заряда.



z, число валентных электронов

Рисунок 3.15 – Спонтанная намагниченность $M_{s exp}$, коэффициенты аномального эффекта Холла R_s и степень спиновой поляризации P [12, 14, 36] в зависимости от числа валентных электронов

В таблицах 3.1 – 3.3 показано, что наименьшие значения остаточного сопротивления, наибольшие значения концентрации носителей тока, намагниченности и температуры Кюри наблюдаются в сплавах Co₂MnSi и Co₂FeSi,

именно тех, для которых ранее в работах [12, 14] сообщалось о ПМФ и высоких значениях коэффициента спиновой поляризации. Так, для сплавов Co₂FeSi и Co₂MnSi $\rho_0 = 10$ и 16 мкОм· см, $M_{s exp} = 5,80$ и 4,76 μ_B/ϕ .е. и концентрация носителей заряда $n \sim 10^{22}$ см⁻³ типичны для металлов, тогда как для Co₂TiSi, Co₂VSi и Co₂CrSi наблюдается высокое остаточное сопротивление $\rho_0 = 155$, 294 и 324 мкОм· см и низкая $M_{s exp} = 1,69$, 0,21 и 0,04 μ_B/ϕ .е., соответственно.

3.5 Выводы по главе 3

При изменении Y-компоненты в сплавах $Co_2 YSi$ (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe), то есть при изменении числа валентных 3*d*-электронов, наблюдается взаимосвязь между зависимостей температурных электросопротивления, видом величинами остаточного электросопротивления, спонтанной намагниченности, коэффициентами нормального и аномального эффекта Холла, концентрацией носителей тока, оптической проводимостью. Данные особенности взаимосвязаны с изменениями плотности электронных состояний в этих сплавах. Наблюдаемые закономерности поведения согласуются с имеющимися экспериментальными данными о степени спиновой поляризации полуметаллических ферромагнетиков Co₂FeSi и Co₂MnSi, определенной методами андреевского отражения в точечном контакте и ультрафиолетовой фотоэмиссионной спектроскопии со спиновым разрешением, соответственно [12, 14].

Исследованные соединения можно разделить на две группы. Первая состоит из полуметаллических ферромагнетиков Co₂FeSi и Co₂MnSi, которые обладают низким остаточным сопротивлением, высокой концентрацией и подвижностью носителей заряда, небольшим аномальным коэффициентом Холла, высокой спонтанной намагниченностью. Вторая группа состоит из сплавов Co₂TiSi, Co₂VSi и Co₂CrSi, для которых наблюдается высокое остаточное сопротивление, большое значение аномального коэффициента Холла, низкая подвижность носителей заряда и малая спонтанная намагниченность, а также оптическая проводимость, не имеющая друдевского подъема при $\omega \rightarrow 0$. Несмотря на величину остаточного сопротивления $\rho_0 \sim 300$ мкОм·см сплавов Co₂VSi и Co₂CrSi, температурный коэффициент сопротивления положительный, правило Муиджи в данном случае не выполняется.

Установлено, что для сплавов Co_2YSi (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe) изменение числа валентных 3d-электронов приводит к изменению плотности электронных состояний на уровне Ферми, что влечет за собой соответствующие изменения следующих характеристик: остаточного электросопротивления, нормального и аномального коэффициентов эффекта Холла, оптической проводимости, спонтанной намагниченности.

Основные результаты, изложенные в данной главе, опубликованы в работах [A1, A2, A4-A7].

4 Электронные и магнитные свойства сплавов Гейслера Co₂MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn)

В главе 3 сообщалось, что плотность электронных состояний N на уровне Ферми для сплавов Co₂YSi сильно изменяется с изменением числа валентных 3*d*электронов. Интересным представляется исследовать особенности поведения электронных, оптических, магнитных характеристик, а также эффекта Холла в сплавах Co₂MnZ при изменении элемента Z (Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn), т.е. при изменении числа *p*-электронов.

В настоящей главе представлены результаты комплексных исследований электронных, магнитных, оптических свойств, а также эффекта Холла сплавов Co₂MnZ. Обнаружено сильное сходство в поведении остаточного электросопротивления, спонтанной намагниченности, нормального и аномального коэффициентов Холла и степени спиновой поляризации² в зависимости от атомного номера элемента Z.

4.1 Температурные зависимости электросопротивления

На рисунке 4.1 (а) представлены температурные зависимости удельного электросопротивления $\rho(T)$ сплавов Co₂MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn). Видно, что $\rho(T)$ всех сплавов имеет металлический вид, т.е. электросопротивление возрастает с ростом температуры. При этом по величине удельного сопротивления это либо «хорошие» металлы (Co₂MnSi, Co₂MnGe, Co₂MnSn), либо высокорезистивные металлические соединения (Co₂MnAl, Co₂MnGa).

Поскольку в масштабе рисунка 4.1 (а) трудно сравнить вид температурных зависимостей, был построен рисунок 4.1 (б), по оси ординат отложена величина относительного сопротивления ($\rho - \rho_0$)/ ρ_0 , где ρ_0 – остаточное сопротивление.

² Приводятся литературные данные.



Рисунок 4.1 – (а) Температурные зависимости электросопротивления; (б) температурные зависимости относительного электросопротивления Со₂MnZ

В таблице 4.1 приведены значения остаточного сопротивления для всех сплавов Co₂MnZ. При температурах T > 100 K зависимость относительного сопротивления становится линейной для Co₂MnSi, Co₂MnGe, как показано на рисунке 4.1 (б), что означает сильную металлическую зависимость. Стоит отметить, что сильная металлическая зависимость наблюдается при Z = Si и Ge – металлоидах, а при Z = Ga, Al, Sn, которые являются металлами, металлическая зависимость выражена слабее.

Достаточно большие значения $\rho \sim (240-290)$ мкОм·см сплавов Co₂MnAl и Co₂MnGa можно объяснить наличием в них небольшого беспорядка. Известно так называемое правило Муиджи (Mooij rule) [68, 70], согласно которому в металлических системах со статическим беспорядком, т.е. с удельным сопротивлением $\rho > (150-200)$ мкОм·см, обычно наблюдается отрицательный ТКС. В случае соединений Гейслера Co₂MnAl и Co₂MnGa правило Муиджи, действительно, выполняется – при низких температурах (до 50 K) на зависимостях удельного сопротивления наблюдается минимум, т.е. присутствует отрицательный ТКС, как видно на рисунке 4.2.

Таблица 4.1 – Атомный номер, остаточное сопротивление ρ_0 , коэффициенты A, B сплавов Co₂MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn)

C	Атомный	$ ho_{0}$,	A, 10 ⁻²	B , 10 ⁻³	
Сплав	номер	мкОм∙см	мкОм·см·К ⁻¹	мкОм·см·К -2	
Co ₂ MnAl	13	237	$-4,7 \pm 10^{-5}$	$0,5 \pm 10^{-5}$	
Co ₂ MnSi	14	16	$-1,3 \pm 0,1$	0,36 ± 0,02	
Co ₂ MnGa	31	273	$-5,7 \pm 0,4$	$0,\!92\pm0,\!06$	
Co ₂ MnGe	32	24	$-0,2 \pm 0,2$	$0{,}50\pm0{,}05$	
Co ₂ MnSn	50	20	$-0,6 \pm 0,4$	$0,\!27\pm0,\!08$	



Рисунок 4.2 – Температурная зависимость удельного электросопротивления ho(T) при 4,2 К $\leq T \leq 50$ К

Известно [48], что при низких температурах в ферромагнитных материалах важную роль играет механизм рассеяния носителей тока на неоднородностях магнитной подсистемы, поэтому температурная зависимость электросопротивления металла подчиняется формуле (3.1) [48, 69]. Как показано на рисунке 4.2, зависимость вида (3.1) наблюдается для всех исследованных сплавов. Точками обозначены экспериментальные данные, а сплошными линиями – результат подгонки, согласно формуле (3.1). Определенные по формуле (3.1) коэффициенты A и B представлены в таблице 4.1.

Для всех сплавов системы Co₂MnZ результат подгонки дает отрицательный знак коэффициента A (таблица 3.1), который связан с наличием щели на уровне Ферми для одного направления спина, как видно на рисунке 4.9, т.е. «полупроводниковый» вклад в сопротивление начинает играть определяющую роль. Эксперимент показывает, что при очень низких температурах (T < 15 K) сопротивление Co₂MnSi и Co₂MnGa недостаточно хорошо описывается формулой (3.1), поэтому для этих соединений на рисунке 4.2 приведена зависимость в диапазоне 15 K $\leq T \leq$ 50 K.

В отсутствие электрон-магнонного рассеяния температурная зависимость электросопротивления отклоняется от квадратичного закона и описывается формулой (1.8). Температурная зависимость электросопротивления соединения Co₂MnAl описывается формулой (3.1) вплоть до температуры 4,2 К. Сопротивление соединений Co₂MnGe и Co₂MnSn изменяется в очень небольшом диапазоне температур и имеет сильный разброс, поэтому погрешность при определении коэффициентов A оказывается значительной. Соединение Co₂MnSn при очень низких температурах имеет отрицательный ТКС. Температурная зависимость электросопротивления этого соединения имеет сильный излом, который не описывается формулой (3.1).

Далее проводились измерения намагниченности, эффекта Холла и оптических свойств для получения дополнительной информации об электронных и магнитных характеристиках сплавов Co₂MnZ.

4.2 Намагниченность и эффект Холла

На рисунке 4.3 представлены полевые зависимости намагниченности M(H) сплавов Co₂MnZ, измеренные при T = 5 К. Все исследованные материалы Co₂MnZ являются ферромагнитными с температурой Кюри [25] существенно выше комнатной, как показано в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Спонтанная намагниченность $M_{s exp}$, степень спиновой поляризации носителей заряда *P* и температуры Кюри T_c сплавов Co₂MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn)

Силар	$M_{ m s\ exp}$,	<i>P</i> , %	<i>T_c</i> , K	
Chulde	μ _B /φ.e.	[37]	[25]	
Co ₂ MnAl	3,96	65,2	693	
Co ₂ MnSi	4,76	93,0 [12]	985	
Co ₂ MnGa	3,27	63,4	694	
Co ₂ MnGe	4,78	100,0	905	
Co ₂ MnSn	4,88	76,0 [72]	829	

Из экспериментальных данных были определены значения спонтанной намагниченности $M_{\rm s\ exp}$, которые приведены в таблице 4.2. Восприимчивость парапроцесса очень мала, поэтому не приводится. Взятые из литературных данных степени спиновой поляризации носителей заряда [12, 37, 72] приведены в таблице 4.2. Рассчитанные полные магнитные моменты $M_{\rm total}$ сплавов Co₂MnZ, приведенные в таблице 4.4, удовлетворительно соответствует экспериментальному магнитному моменту $M_{\rm s\ exp}$ (см. таблицу 4.2). Причем рассчитанные значения несколько превышают экспериментальные, так как при расчете магнитных моментов не учитываются возможные дефекты структуры поликристаллических образцов [42, 71].



Рисунок 4.3 – Полевые зависимости намагниченности Co_2MnZ при T = 5 K

На рисунке 4.4 показано сопротивление Холла в зависимости от намагниченности сплавов Co₂MnZ при T = 4,2 К. Сравнивая рисунки 4.3 и 4.4, стоит отметить, что вблизи H = 0 сопротивление Холла возрастает при увеличении поля, что согласуется с изменением намагниченности. В полях свыше (3-5) кЭ намагниченность всех сплавов выходит на насыщение, а сопротивление Холла увеличивается, за исключением соединений Co₂MnGe и Co₂MnSi, у которых сопротивление Холла в полях выше 5 кЭ падает. Это говорит о том, что носителями заряда в Co₂MnGe и Co₂MnSi являются электроны, а для определения типа основных носителей в остальных соединениях требуется обработка результатов по формуле (2.9).



Рисунок 4.4 – Сопротивление Холла сплавов Co₂MnZ при *T* = 4,2 К в зависимости от напряженности магнитного поля

По формуле (2.9) были определены нормальный R_0 и аномальный R_s коэффициенты Холла, тип основных носителей заряда (таблица 4.3, рисунок 4.5). Видно, что коэффициент R_s превышает R_0 на два-три порядка, что характерно для ферромагнитных сплавов, аналогично сплавам Co₂*Y*Si (см. раздел 3.2). Для всех исследованных сплавов, независимо от типа носителей заряда, коэффициенты аномального эффекта Холла положительны. Соединения Co₂MnGa, Co₂MnAl и Co₂MnSn обладают положительным коэффициентом нормального эффекта Холла, а значит, основными носителями заряда являются дырки. Интересно отметить, что среди исследованных сплавов основными носителями заряда являются дырки. Интересно отметить, что среди исследованных сплавов основными носителями заряда являются электроны только для Co₂MnGe и Co₂MnSi – соединений, которые обладают сходными химическими свойствами.



Рисунок 4.5 – Зависимость $\rho_{xy}/H = f(M/H)$ для сплавов Co₂MnZ

Оценка концентрации и подвижности носителей заряда проведена с использованием однозонной модели, результаты приведены в таблице 4.3. Измерения проводились на поликристаллических образцах, поэтому оценки концентрации n и подвижности μ носителей заряда носят качественный характер. Для точного определения знака, концентрации и подвижности носителей тока, их вклада в электронные транспортные свойства необходимы данные о деталях их поверхностей Ферми, которые в настоящее время отсутствуют. Поэтому для оценки концентрации и подвижности носителей заряда использовалась однозонная модель.

Как показано в таблице 4.3, нормальный коэффициент Холла соединения Co₂MnGe имеет малую величину, поэтому оценка концентрации и подвижности носителей заряда по однозонной модели не имеет смысла.

84

Для соединений Co₂MnAl и Co₂MnGa наблюдается низкая концентрация носителей заряда, порядка $10^{20} - 10^{21}$ см⁻³ (см. таблицу 4.3), что согласуется с «плохими» металлическими свойствами (в частности, высоким остаточным сопротивлением), как показано в разделе 4.1. Co₂MnSi и Co₂MnSn имеют типичную для металлов концентрацию ~ 10^{22} см⁻³.

Таблица 4.3 – Тип основных носителей заряда, нормальный R_0 и аномальный R_s коэффициенты Холла, концентрация n и подвижность μ носителей заряда сплавов Co₂MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn)

Силар	Тип носителя	$R_{0}, 10^{-4}$	R_{s} , 10 ⁻²	<i>n</i> , 10 ²²	μ,
Сплав	заряда	см ³ /Кл	см ³ /Кл	см ⁻³	$cM^2/(B\cdot c)$
Co ₂ MnAl	дырки	52 ±12	$25,7 \pm 0,4$	0,11	22,2
Co ₂ MnSi	электроны	$-1,5 \pm 0,1$	$0,040 \pm 0,001$	4,0	9,7
Co ₂ MnGa	дырки	$92,8 \pm 2,8$	4,6 ± 0,1	0,07	34,0
Co ₂ MnGe	электроны	$-0,10 \pm 0,02$	$0,90 \pm 0,01$	-	-
Co ₂ MnSn	дырки	3,3 ± 0,6	0,80 ±0,02	1,90	16,3

4.3 Оптические свойства

Монотонное возрастание реальной $|\varepsilon_1(\omega)|$ и мнимой $\varepsilon_2(\omega)$ частей диэлектрической постоянной, как показано на рисунке 4.6, наблюдается для всех сплавов Co₂MnZ при увеличении длины волны падающего света.

Это означает, что в инфракрасной области механизм внутризонного поглощения света играет главную роль в формировании оптических свойств всех сплавов Co₂MnZ. Отрицательные значения реальной части диэлектрической постоянной $\varepsilon_1(\omega)$, которая характеризует соединения как металл, указывает на присутствие свободных носителей в каждом сплаве, но со значительно различными концентрациями. Мнимая часть диэлектрической постоянной для сплавов Co₂MnAl и Co₂MnGa отрицательна не во всем волновом диапазоне, что указывает

на «плохие» металлические свойства данных соединений. Это согласуется с температурными зависимостями электросопротивления, где наблюдается отрицательный температурный коэффициент сопротивления.



Рисунок 4.6 – Дисперсия реальной ε₁(ω) (ниже нуля по оси ординат) и мнимой ε₂(ω) (выше нуля на оси ординат) частей диэлектрической постоянной сплавов Co₂MnZ

На рисунке 4.7 показана отражательная способность R(λ). Для «хороших» металлов в инфракрасной области отражательная способность близка к 1 и резко снижается при появлении интенсивного межзонного поглощения.



Рисунок 4.7 – Отражательная способность сплавов Co₂MnZ

В длинноволновой части спектра значения $R(\lambda)$ изменяются плавно, такое поведение характерно для области, где преобладает внутризонное поглощение света. Наиболее резкий спад $R(\lambda)$ наблюдается для сплавов Co₂MnSi и Co₂MnSn и происходит в области длин волн $\lambda < 4$ мкм. Для Co₂MnGa уменьшение $R(\lambda)$ из-за включения межзонных переходов более плавное и начинается примерно при $\lambda < 7$ мкм. В сплаве Co₂MnAl в инфракрасной области значения $R(\lambda)$ самые низкие среди всех сплавов Co₂MnZ.

На рисунке 4.8 представлен спектр оптической проводимости для соединений Co₂MnZ. В инфракрасной области спектра имеется участок друдевского поглощения для всех соединений, за исключением Co₂MnAl и Co₂MnGa. При энергии $E \sim 0.6$ эВ для сплавов Co₂MnSi, Co₂MnSn начинается интенсивное межзонное поглощение. Co₂MnGe также проявляет хорошие металлические свойства: в инфракрасной области наблюдается межзонное поглощение на фоне друдевского подъема. Оптическая проводимость $\sigma(\omega)$ сплава Co₂MnAl показывает аномальное поведение: она не имеет друдевского поглощения вплоть до границы исследованного спектрального интервала λ =18 мкм.

Статическая проводимость, полученная из измерений электросопротивления при комнатной температуре, равна $30,9 \cdot 10^{14} \text{ c}^{-1}$ для Co₂MnGa; $36,7 \cdot 10^{14} \text{ c}^{-1}$ для Co₂MnAl; $301 \cdot 10^{14} \text{ c}^{-1}$ для Co₂MnSn; $195 \cdot 10^{14} \text{ c}^{-1}$ для Co₂MnGe; $275 \cdot 10^{14} \text{ c}^{-1}$ для Co₂MnSi.

Анализ зависимости $1/\epsilon_1 = f(\omega^2)$, согласно формуле (1.4) дает оценку квадрата плазменной частоты электронов проводимости Ω^2 : ~22·10³⁰ c⁻² для Co₂MnSi, ~14·10³⁰ c⁻² для Co₂MnSn.

Оценки частоты релаксации, которая характеризует различные механизмы поглощения световой волны, дают значения $\gamma = 0.7 \cdot 10^{-14} \text{ c}^{-1}$ для сплава Co₂MnSn и $\gamma = 2 \cdot 10^{-14} \text{ c}^{-1}$ для сплава Co₂MnSi. Для остальных сплавов γ не определялась, поскольку существенный вклад в проводимость вносит межзонное поглощение.



Рисунок 4.8 – Дисперсия оптической проводимости 6(ω) сплавов Co₂MnZ

Из соотношения $N_{_{3\phi\phi}} = \Omega^2 \cdot m/_{(4\pi \cdot e^2)}$ (*е* и *m* – заряд и масса свободного электрона, соответственно) были получены оценки эффективной концентрации носителей заряда, типичные для металлов: $N_{_{3\phi\phi}} \sim 10^{22}$ см⁻³ для всех сплавов Co₂MnZ. Сравнивая полученные значения эффективной концентрации с данными раздела

4.2, нужно отметить, что данная оценка дает результат, согласующийся с данными таблицы 4.3 только для «хороших» металлов Co₂MnSi и Co₂MnSn.

4.4 Взаимосвязь электронных и магнитных свойств

Ранее в работах [12, 26] на основании ультрафиолетовой фотоэмиссионной спектроскопии со спиновым разрешением для Co₂MnSi и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (HAXPES) для Co₂MnGe был сделан вывод о реализации ПМФ-состояния в этих материалах. При этом в данных сплавах реализуются высокие значения спиновой поляризации (см. таблицу 4.2).

Для выяснения роли особенностей плотности состояний на уровне Ферми в формировании электронных свойств и магнитного состояния исследуемых соединений Гейслера Co_2MnZ при изменении Z-компоненты обратимся к расчетам электронной зонной структуры³. На рисунке 4.9 продемонстрирована плотность электронных состояний *N*, рассчитанная на основе полученных в данной работе экспериментальных данных о структуре и параметрах решетки. Уровень Ферми расположен в нуле энергий и показан вертикальной пунктирной линией.

Электронная структура сплавов Гейслера Co_2MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Sn) рассчитана с помощью теории функционала плотности (DFT) с обменнокорреляционным функционалом в обобщенном градиентном приближении (GGA) версии Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [38]. Использовалось программное обеспечение Quantum Espresso [39].

В таблице 4.4 приведены магнитные моменты, плотности электронных состояний и степень спиновой поляризации рассматриваемых соединений Co₂MnZ. Видно, что в сплавах Co₂YSi полный магнитный момент M_{total} различается значительно от 0 до 5 μ_{B}/ϕ .е. при изменении компоненты Y, а в сплавах Co₂MnZ M_{total} имеет близкие величины 4 – 5 μ_{B}/ϕ .е. для всех соединений при изменении компоненты Z.

³Готовится в печать [А.А. Семянникова, А.В. Лукоянов, В.В. Марченков и др.]



Рисунок 4.9 – Плотность электронных состояний *N*(*E*) для обеих проекций спина сплавов Гейслера Co₂MnZ

	Таблица	4.4 –	Магнитный	момент,	плотность	электронных	состояний	на
уров	не Ферми	и степ	ень спиновой	і́ поляриз	ации Со ₂ М	nZ(Z = Al, Si, q)	Ga, Ge, Sn)	

Состав	$M_{\rm Co}, \qquad M_{M_I}$ $\mu_{\rm B} \qquad \mu_{\rm B}$	$M_{Mn},$	$egin{array}{ccc} M_{Mn}, & M_Z, \ \mu_{ m B} & \mu_{ m B} \end{array}$	$M_{ m total},$ $\mu_{ m B}/\Phi.e.$	N, состояния / (эВ · ячейка)			Степень спиновой
		μ_{B}			вверх	вниз	общее	поляризации
Co ₂ MnAl	0,74	2,86	-0,22	4,12	0,88	0,27	1,15	0,53
Co ₂ MnSi	1,02	3,05	-0,09	5,00	2,02	0,00	2,02	1,00
Co ₂ MnGa	0,73	2,91	-0,15	4,22	1,80	0,57	2,37	0,52
Co ₂ MnGe	0,98	3,13	-0,08	5,01	1,89	0,00	1,89	1,00
Co ₂ MnSn	0,97	3,30	-0,14	5,10	1,49	0,29	1,78	0,67

В связи с тем, что электронные свойства металлов определяются электронными состояниями вблизи уровня Ферми, интересно проследить как изменяются плотности электронных состояний при изменении Z-компоненты в соединениях Co₂MnZ.

На рисунке 4.9 видно, что для электронных состояний со спином «вниз» в этих соединениях Co₂MnSi и Co₂MnGe существует щель. Кроме того, Co₂MnSi и Co₂MnGe имеют высокие значения полного магнитного момента, металлический тип поведения температурной зависимости электросопротивления, друдевский подъем на кривой оптической проводимости, как показано в разделах 4.1 – 4.3, т.е. данные соединения обладают металлическими свойствами. Полученные результаты согласуются с тем, что данные материалы являются ПМФ [12, 26].

В главе 3 рассматривалось влияние изменения валентных 3*d*-электронов на плотность электронных состояний вблизи уровня Ферми. Можно предположить, что при изменении числа *p*-электронов в сплавах Гейслера Co_2MnZ (Z = Al, Si, Ga,Ge, Sn) могут также наблюдаться особенности поведения электронных и магнитных характеристик. Плотность электронных состояний на уровне Ферми зависит и от числа валентных электронов, и от атомного номера. Но для сплавов Co₂MnAl и Co₂MnGa число валентных электронов равно 28, а для сплавов Co₂MnSi, Co₂MnGe и Co₂MnSn – 29. Поэтому невозможно проследить за изменением электронных и магнитных характеристик при варьировании числа валентных электронов – всего 2 значения. При этом плотность электронных состояний для сплавов с разным элементом Z изменяется. Поэтому на оси абсцисс указаны значения атомных номеров Z-компонентов сплавов Co_2MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn) в порядке их возрастания. Хотя при этом шкала по оси абсцисс является «нелинейной», но все же такое представление результатов позволяет провести их качественный анализ и сравнить между собой, поскольку плотность электронных состояний на *E*_F при этом изменяется. Каждой точке на графиках (рисунки 4.10 – 4.14) соответствует конкретное соединение Co₂MnZ, но для удобства указаны только названия элементов Z каждого из сплавов.

На рисунке 4.10 показана зависимость плотности электронных состояний *N* на уровне Ферми в зависимости от атомного номера элемента *Z* для соединений Co₂Mn*Z*, согласно данным таблицы 4.4.



Рисунок 4.10 – Плотности электронных состояний на *E*_F для сплавов Co₂MnZ в зависимости от атомного номера *Z*-компоненты

На рисунке 4.11 приведена зависимость коэффициентов нормального эффекта Холла R_0 от атомного номера элемента Z. Видно, что поведение обеих зависимостей (рисунки 4.10 и 4.11) взаимосвязано. В обоих случаях максимум наблюдается для соединения Co₂MnGa; Ga имеет атомный номер 31. Стоит отметить, что Co₂MnAl «выбивается» из этой зависимости, так как при низкой плотности электронных состояний он имеет большое значение нормального коэффициента Холла.

На рисунке 4.12 показаны графики остаточного сопротивления и коэффициента аномального эффекта Холла *R*_s в зависимости от атомного номера элемента *Z*, которые согласуются с данными на рисунке 4.11.

Видно, что ρ_0 и R_s подобны друг другу. Интересно отметить, что для исследованных сплавов Co₂MnZ зависимости от атомного номера коэффициентов R_0 и R_s ведут себя похожим образом, что отличается от соединений Co₂YSi (см. раздел 3.4), где поведение коэффициентов нормального и аномального эффекта Холла в зависимости от числа валентных электронов прямо противоположно (см. рисунки 3.11 и 3.12).



Рисунок 4.11 – Коэффициенты нормального эффекта Холла *R*₀ в зависимости от атомного номера элемента *Z*



Рисунок 4.12 – Остаточное сопротивление ρ_0 и коэффициенты аномального эффекта Холла R_s в зависимости от атомного номера элемента Z

Рассмотрим, каким образом ведут себя другие электронные свойства, например, оптические, при изменении Z-компоненты в ряду от Al до Sn, т.е. с возрастанием их атомного номера. На рисунке 4.13 показана оптическая проводимость б при энергии E = 0,155 эВ и проводимости $1/\rho_{RT}$ при комнатной температуре в зависимости от атомного номера элемента Z.



Рисунок 4.13 – Проводимость 1/ ρ_{RT} при комнатной температуре и оптическая проводимость б в зависимости от атомного номера элемента Z

В целом поведение электропроводности и оптической проводимости согласуется между собой. Однако стоит отметить интересную особенность оптической проводимости Co₂MnGe (см. рисунок 4.8). Резкий друдевский спад начинается при достаточно низких энергиях падающего света для этого соединения. Поэтому уже при E = 0,155 эВ для соединения Co₂MnGe получается заниженная оценка оптической проводимости.

Обратимся к магнитным характеристикам. Как видно на рисунке 4.14, существует определенная корреляция между спонтанной намагниченностью $M_{\rm s \ exp}$, коэффициентами аномального эффекта Холла $R_{\rm s}$ и степенью спиновой поляризации P [12, 37, 72] в зависимости от атомного номера элемента Z исследованных соединений. Степени спиновой поляризации были взяты из литературы. Методы определения степени спиновой поляризации: Co₂MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Sn) – расчеты на основе теории функционала плотности, Co₂MnSi – ультрафиолетовая фотоэмиссионная спектроскопия со спиновым разрешением (см. таблицу 4.2).



Рисунок 4.14 – Спонтанная намагниченность $M_{s exp}$, коэффициенты аномального эффекта Холла R_s и степень спиновой поляризации P [12, 37, 72] в зависимости от атомного номера элемента Z

Сравнивая поведение спонтанной намагниченности $M_{s exp}$ со степенью спиновой поляризации P (рисунок 4.14), видим, что зависимости этих величин от атомного номера элемента Z аналогичны. С другой стороны, спонтанная намагниченность и аномальный коэффициент Холла имеют «обратную» зависимость: для Co₂MnSi и Co₂MnGe наблюдается минимум R_s , а для $M_{s exp}$ – максимум для этих соединений. Минимумы на зависимости аномальных коэффициентов Холла соответствуют максимумам на кривых для спонтанной намагниченности и коэффициента спиновой поляризации.

Особый интерес представляют два соединения: Co₂MnSi и Co₂MnGe, которые являются ПМФ-материалами [12, 26] с близкой к 100 % спиновой поляризацией носителей тока. Видно, что значения электросопротивления для них относительно малы: $\rho_0 = 16$ и 24 мкОм·см, соответственно. В то же время, величины намагниченности этих соединений, напротив, достаточно большие: $M_{\rm s exp} = 4,76$ и 4,78 µ_B/ф.е. Именно так и должно быть, когда в проводимости участвуют только «металлические» носители тока, которые дают большой вклад в намагниченность, что, по-видимому, и может приводить к высокой спиновой поляризации носителей, как и показано на рисунке 4.14, степень спиновой поляризации носителей заряда составляет 93 и 100 %, соответственно.

Стоит отметить, что большое значение коэффициента аномального эффекта Холла в соединениях Co₂MnAl и Co₂MnGa и высокое остаточное сопротивление могут свидетельствовать, согласно [5], о проявлении состояний топологического полуметалла, но этот вопрос требует дополнительных исследований. Об аномальном поведении Co₂MnAl также свидетельствует отсутствие друдевского подъема на кривой оптической проводимости. Данное поведение характеризует Co₂MnAl как плохой металл и согласуется с аномальным поведением электросопротивления (отрицательный TKC при низких температурах). Соединение Co₂MnGa также обладает отрицательным TKC.

Таким образом, в зависимости от атомного номера компоненты Z наблюдаются корреляции поведения электросопротивления, намагниченности, эффекта Холла и степени спиновой поляризации.

96

4.5 Выводы по главе 4

В результате проведенных исследований электронных и магнитных свойств соединений Гейслера Co₂MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn), экспериментально выявлена взаимосвязь между электрическими, магнитными и оптическими свойствами в зависимости от атомного номера элемента Z при вариации *p*-элементов в сплавах Co₂MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn).

В полуметаллических ферромагнетиках Co₂MnSi и Co₂MnGe с атомным номером Z-элемента равным 14 и 32, соответственно, наблюдаются относительно малые значения электросопротивления $\rho_0 = 16$ и 24 мкOм·см, а величины спонтанной намагниченности, напротив, достаточно большие: $M_{\rm s\ exp} = 4,76$ и 4,78 $\mu_{\rm B}/\phi$.е., что соответствует известным из литературы высоким значениям степени спиновой поляризации. Результаты измерений оптических свойств и электросопротивления также подтверждают хорошие металлические свойства Co₂MnSi и Co₂MnGe.

Установлено, что зависимости остаточного сопротивления, коэффициентов нормального и аномального эффекта Холла, оптической проводимости, электропроводности при комнатной температуре, спонтанной намагниченности от атомного номера элемента *Z* подобны друг другу. Корреляция с изменением плотности электронных состояний на уровне Ферми существует, но не так сильно выражена по сравнению с таковой при изменении *3d*-элементов, как показано в главе 3.

Основные результаты, изложенные в данной главе, опубликованы в работах [A2, A3].

Заключение

В диссертационной работе получены следующие основные результаты и сделаны выводы:

1. Синтезированы соединения Гейслера $Co_2 YSi$ и $Co_2 MnZ$ (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe; *Z* = Al, Ga, Ge, Si, Sn), проведена их структурная аттестация.

2. Экспериментально установлены закономерности поведения электронных транспортных характеристик, таких как коэффициенты нормального и аномального эффекта Холла, остаточное сопротивление, оптическая проводимость, при изменении *Y*-составляющей в сплавах Co_2YSi (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe), то есть при изменении числа валентных 3*d*-электронов. Обнаружена связь спонтанной намагниченности с электронными характеристиками данных сплавов, в том числе с плотностью электронных состояний на уровне Ферми.

3. Установлено, что при очень большой для металлических соединений величине остаточного сопротивления $\rho_0 \sim 300$ мкОм·см температурный коэффициент сопротивления положителен во всей исследованной области температур от 4,2 K до 300 K, т.е. для сплавов Co₂VSi и Co₂CrSi правило Муиджи не выполняется.

4. Экспериментально обнаружены корреляции между поведением остаточного сопротивления, оптической проводимости, коэффициентами нормального и аномального эффекта Холла, а также спонтанной намагниченности в зависимости от Z-составляющей в сплавах Co₂MnZ (Z = Al, Ga, Ge, Si, Sn).

Таким образом, экспериментально установлены закономерности поведения и взаимосвязь между электронными транспортными, оптическими и магнитными свойствами сплавов Гейслера Co₂*Y*Si и Co₂Mn*Z* (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe; *Z* = Al, Ga, Ge, Si, Sn) при изменении их *Y*- и/или *Z*-компоненты.

Благодарности

Автор выражает огромную благодарность научному руководителю В.В. Марченкову за открытие научного мира, бесконечный энтузиазм, а также за внимательное прочтение рукописи и ценные замечания во время подготовки диссертации.

Автор также благодарит к.ф.-м.н. А.В. Лукоянова, к.ф.-м.н. Е.И. Шредер, к.ф.-м.н. Е.Б. Марченкову, д.ф.-м.н. В.Ю. Ирхина, д.ф.-м.н. В.Н. Неверова и к.ф.м.н. А.В. Королева за плодотворное сотрудничество и предоставленную возможность провести комплексные и всесторонние исследования, а также за обсуждение полученных результатов.

Автор выражает глубокую благодарность коллегам из лаборатории низких температур за дружескую атмосферу, отзывчивость и интересную совместную работу.

Особую благодарность автор выражает своей семье за поддержку и терпение в период обучения в аспирантуре и написания диссертации.

Публикации автора по теме диссертации

A1. Electronic properties and electronic structure of Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) Heusler alloys / A.A. Semiannikova, Yu.A. Perevozchikova, A.V. Lukoyanov, E.I. Shreder, A.A. Makhnev, P.S. Korenistov, V.V. Marchenkov // IEEE Trans. Magn. – 2022. – Vol. 58. – P. 2600205.

A2. Electronic, magnetic and galvanomagnetic properties of Co-based Heusler alloys: possible states of a half-metallic ferromagnet and spin gapless semiconductor / A.A. Semiannikova, Yu.A. Perevozchikova, V.Yu. Irkhin, E.B. Marchenkova, P.S. Korenistov, V.V. Marchenkov // AIP Adv. – 2021. – Vol. 11. – P. 015139.

А3. Магнитные и электрические свойства соединений Гейслера Co₂MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn) / А.А. Семянникова, Ю.А. Перевозчикова, П.С. Коренистов, Е.Б. Марченкова, В.В. Марченков // ФММ. – 2022. – Т. 123, № 7. – С. 753.

А4. Экспериментальное наблюдение аномалий электрических, магнитных и гальваномагнитных свойств сплавов Гейслера на основе кобальта при изменении содержания переходных элементов / Ю.А. Перевозчикова, А.А. Семянникова, А.Н. Доможирова, П.Б. Терентьев, Е.Б. Марченкова, Е.И. Патраков, М. Eisterer, П.С. Коренистов, В.В. Марченков // ФНТ. – 2019. – Т. 45, №7. – С. 921.

A5. Features of the electroresistivity, magnetic and galvanomagnetic characteristics in Co_2MeSi Heusler alloys / V.V. Marchenkov, Yu.A. Perevozchikova, A.A. Semi-annikova, P.S. Korenistov, E.B. Marchenkova, A.N. Domozhirova // Φ HT. – 2021. – Vol. 47. – P. 683.

A6. Strong changes in electronic transport and magnetic properties of Co₂*Y*Si Heusler alloys at *Y*-component variation / Yu.A. Perevozchikova, A.A. Semiannikova, P.B. Terentyev, M. Eisterer, P.S. Korenistov, V.V. Marchenkov // J. Phys. Conf. Ser. – 2019. – Vol. 1389. – P. 012110.

A7. Peculiarities of the electronic and magnetic characteristics in Co_2YSi (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) Heusler alloys close to the half-metallic ferromagnets and spin gapless semiconductors / Yu.A. Perevozchikova, A.A. Semiannikova, P.S. Korenistov, V.V. Marchenkov // J. Phys. Conf. Ser. – 2020. – Vol. 1695. – P. 012143.

Публикации в трудах всероссийских и международных конференций:

A8. Electronic properties and electronic structure of Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) Heusler alloys / A.A. Semiannikova, Yu.A. Perevozchikova, A.V. Lukoyanov, E.I. Shreder, A.A. Makhnev, P.S. Korenistov, V.V. Marchenkov // IEEE International Magnetics Virtual Conference (INTERMAG21), Digest book, 26-30 апреля 2021 г., Лион, Франция. – 2021. – P. 651.

A9. Electronic, magnetic and galvanomagnetic properties of Co-based Heusler alloys in the states of half-metallic ferromagnet and spin gapless semiconductor / A.A. Semiannikova, Yu.A. Perevozchikova, P.B. Terentyev, P.S. Korenistov, V.V. Marchenkov // The 65th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM 2020), Abstracts, 2-6 ноября 2020 г., США. – 2020. – P. 232.

A10. Electronic properties of the half-metallic ferromagnet Co₂MnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge) Heusler compounds / A.A. Semiannikova, Yu.A. Perevozchikova, E.B. Marchenkova, V.V. Marchenkov // International Conference Functional Materials (ICFM 2021), Book of abstracts, 4-8октября 2021 г., Крым. – 2021. – Р. 27.

A11. Strong changes in electronic transport and magnetic properties of Co₂*Y*Si Heusler alloys at *Y*-component variation / Yu.A. Perevozchikova, A.A. Semiannikova, P.B. Terentyev, M. Eisterer, P.S. Korenistov, V.V. Marchenkov // VII Euro-Asian Symposium «Trends in MAGnetism» EASTMAG-2019, Book of abstracts, 08-13 сентября 2019 г., Екатеринбург. – 2019. – Vol. I. – P. 80.

А12. Особенности кинетических и магнитных свойств сплавов Гейслера Mn₂YA1 и Co₂FeZ / А.А. Семянникова, В.Ю. Ирхин, А.Н. Доможирова, Ю.А. Перевозчикова, П.С. Коренистов, В.В. Марченков // Современные проблемы физики и технологий. VIII-я Международная молодежная научная школаконференция, Сборник тезисов докладов. Часть 2. 15-20 апреля 2019 г. М.: НИЯУ МИФИ. – 2019. – С. 280.

А13. Семянникова, А.А. Особенности магнитных и гальваномагнитных свойств сплавов Гейслера Co₂*Y*Si (*Y* = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) / А.А. Семянникова, Ю.А. Перевозчикова, В.В. Марченков // Сборник тезисов, материалы Двадцать

пятой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-25), 19-26 апреля 2019 г., Крым: тезисы докладов, издательство АСФ России. – 2019. – Т.1. – С. 113.

А14. Электрические, магнитные и гальваномагнитные свойства сплавов Гейслера Co₂*Y*Si при изменении переходных элементов / А.А. Семянникова, Ю.А. Перевозчикова, П.Б. Терентьев, А.Н. Доможирова, В.В. Марченков // Тезисы докладов XX Юбилейной Всероссийской школы-семинара по проблемам физики конденсированного состояния вещества, 21-28 ноября 2019 г., Екатеринбург. – 2019. – С. 126.

А15. Магнитные и электронные транспортные свойства полуметаллических ферромагнитных сплавов Гейслера на основе Со / Ю.А. Перевозчикова, А.А. Семянникова, А.Н. Доможирова, В.В. Чистяков, П.Б. Терентьев, В.В. Марченков // Тезисы докладов XIX Всероссийской школы-семинара по проблемам физики конденсированного состояния вещества 15-22 ноября 2018 г., Екатеринбург. – 2018. – С. 110.

Список литературы

New class of materials: half-metallic ferromagnets / R.A. de Groot, F.M. Mueller,
 P.G. van Engen, and K.H.J. Buschow // Phys. Rev. Lett. – 1983. – Vol. 50. – P. 2024.

2. Ирхин, В.Ю. Полуметаллические ферромагнетики / В.Ю. Ирхин, М.И. Кацнельсон // УФН. – 1994. – Vol. 164. – Р. 705.

3. McGuire, T.R. Ferromagnetic Europium Compounds / T.R. McGuire, M.W. Shafer // J. Appl. Phys. – 1964. – Vol. 35(3). – P. 984.

Graf, T. Simple rules for the understanding of Heusler compounds / T. Graf, C.
Felser, S.S.P. Parkin // Prog. Solid State Chem. – 2011. – Vol. 39. – P. 1.

5. Heusler, Weyl, and Berry / K. Manna, Y. Sun, L. Muechler, J. Kübler, C. Felser // Nat. Rev. Mater. – 2018. – Vol. 3. – P. 244.

Heusler 4.0: Tunable Materials / L. Wollmann, A.K. Nayak, S.S.P. Parkin, C.
 Felser // Annu. Rev. Mater. Res. – 2016. – Vol. 47. – P. 247.

Wang, X.L. Proposal for a new class of materials: spin gapless semiconductors
/ Wang, X.L. // Phys. Rev. Lett. - 2008. - Vol. 100. - P. 156404.

Spin-gapless semiconductors / Z. Yue, Z. Li, L. Sang, X. Wang // Small. –
 2020. – P. 1905155.

9. Realization of spin gapless semiconductors: the Heusler compound Mn₂CoAl /
S. Ouardi, G.H. Fecher, C. Felser, J. Kubler // Phys. Rev. Lett. – 2013. – Vol. 110. –
P. 100401.

Transport properties of Heusler compounds and alloys / S. Chatterjee, S. Chatterjee, S. Giri, S. Majumdar // J. Phys.: Condens. Matter. – 2022. – Vol. 34. – P. 013001.

 Spin gapless semiconducting behavior in equiatomic quaternary CoFeMnSi Heusler alloy / L. Bainsla, A.I. Mallick, M.M. Raja, A.K. Nigam, B.S.D.Ch.S. Varaprasad, Y.K. Takahashi, Aftab Alam, K. G. Suresh, K. Hono // Phys. Rev. B. – 2015. – Vol. 91. – P. 104408.

12. Direct observation of half-metallicity in the Heusler compound Co₂MnSi / M. Jourdan, J. Minar, J. Braun, A. Kronenberg, S. Chadov, B. Balke, A. Gloskovskii, M.

Kolbe, H.J. Elmers, G. Schonhense, H. Ebert, C. Felser, M. Klaui // Nat. Commun. – 2014. – Vol. 5. – P. 3974.

Marchenkov, V.V. Half-metallic ferromagnets and spin gapless semiconductors /
V.V. Marchenkov, N.I. Kourov, V.Y. Irkhin // Phys. Met. Metallogr. – 2018. – Vol. 119.
– P. 1321.

14. On the half-metallicity of Co₂FeSi Heusler alloy: an experimental and *ab initio* study / L. Makinistian, M.M. Faiz, R.P. Panguluri, B. Balke, S. Wurmehl, C. Felser, E.A. Albanesi, A.G. Petukhov, B. Nadgorny // Phys. Rev. B. – 2013. – Vol. 87. – P. 220402.

Peculiarities of the electronic transport in half-metallic Co-based Heusler alloys /
 V.V. Marchenkov, Yu.A. Perevozchikova, N.I. Kourov, V.Yu. Irkhin, M. Eisterer, T.
 Gao // J. Magn. Magn. Mat. – 2018. – Vol. 459. – P. 211.

16. Possible spin gapless semiconductor type behaviour in CoFeMnSi epitaxial thin films / V.K. Kushwaha, J. Rani, A. Tulapurkar, C.V. Tomy // Appl. Phys. Lett. – 2017. – Vol. 111. – P. 152407.

17. Heusler, F. // Verh. Dtsch. Phys. Ges. - 1903. - Vol. 12. - P. 219.

Tavares, S. Heusler alloys: Past, properties, new alloys, and prospects / S. Tavares, K. Yang, M.A. Meyers // Prog. Mater. Sci. – 2023. – Vol. 132. – P. 101017.

Band theory of Co₂MnSn, Co₂TiSn and Co₂TiAl / S. Ishida, S. Akazawa, Y. Kubo,
 J. Ishida // J. Phys. F: Met. Phys. – 1982. – Vol. 12. – P. 1111.

20. Kübler, J. Formation and coupling of magnetic moments in Heusler alloys / J. Kübler, A.R. William, C.B. Sommers // Phys. Rev. B. – 1983. – Vol. 28. – P. 1745.

21. Galanakis I. Slater-Pauling behavior and origin of the half-metallicity of the full-Heusler alloys / I. Galanakis, P. H. Dederichs, N. Papanikolaou // Phys. Rev. B – 2002. – Vol. 66. – P. 174429.

22. Galanakis, I. Electronic structure and Slater–Pauling behaviour in half-metallic Heusler alloys calculated from first principles / I. Galanakis, P. Mavropoulos, P. H. Dederichs // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2006. – Vol. 39. – P. 765.

23. Graf, T. Heusler compounds – a material class with exceptional properties / T. Graf,
S.S.P. Parkin, C. Felser // IEEE Trans. Magn. – 2011. – Vol. 47. – P. 367.

24. Half-metallic ferromagnetism with unexpectedly small spin splitting in the Heusler compound Co₂FeSi / D. Bombor, C.G.F. Blum, O. Volkonskiy, S. Rodan, S. Wurmehl, C. Hess, B. Buchner // Phys. Rev. Lett. – 2013. – Vol. 110. – P. 066601.

25. Webster, P. Magnetic and chemical order in Heusler alloys containing cobalt and manganese / P. Webster // J. Phys. Chem. Solids. – 1971. – Vol. 32. – P. 1221.

26. Electronic and crystallographic structure, hard X-ray photoemission, and mechanical and transport properties of the half-metallic Heusler compound Co₂MnGe / S. Ouardi, G.H. Fecher, B. Balke, A. Beleanu, X. Kozina, G. Stryganyuk, C. Felser // Phys. Rev. B. – 2011. – Vol. 84. – P. 155122.

27. Ирхин, В.Ю. Электронная структура, корреляционные эффекты и физические свойства d- и f- переходных металлов и их соединений // В.Ю. Ирхин, Ю.П. Ирхин. – Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 472 с.

28. Marchenkov, V.V. Peculiarities of electronic transport and magnetic state in halfmetallic ferromagnetic and spin gapless semiconducting Heusler alloys / V.V. Marchenkov, V.Yu. Irkhin, Yu.A. Perevozchikova // Phys. Met. Metallogr. – 2019. – Vol. 120. – P. 1325.

29. Ирхин, В.Ю. Современное модельное описание магнетизма. Статья / В.Ю. Ирхин: [Б.и.], 2010. – 83 с. – URL: https://rucont.ru/efd/13083 (дата обращения: 28.07.2022).

30. Irkhin, V.Yu. Temperature dependences of resistivity and magnetoresistivity for half-metallic ferromagnets / V.Yu. Irkhin, M.I. Katsnelson // Eur. Phys. J. B. – 2002. – Vol. 30. – P. 481.

31. Half-metallic ferromagnets: from band structure to many-body effects / M.I.
Katsnelson, V.Y. Irkhin, L. Chioncel, A.I. Lichtenstein, R.A. De Groot // Rev. Mod. Phys. - 2008. - Vol. 80. - P. 315.

32. Марченков, В.В. Полуметаллические ферромагнетики, спиновые бесщелевые полупроводники и топологические полуметаллы на основе сплавов Гейслера: теория и эксперимент / Марченков В.В., Ирхин В.Ю. // ФММ. – 2021. – Т. 122. – С. 1221.

33. Recent advances in the Heusler based spin-gapless semiconductors / X. Wang,
Z. Cheng, J. Wang, X. Wang, G. Liu // J. Mater. Chem. C. – 2016. – Vol. 4. – P.
7176.

34. Erratum: Realization of spin gapless semiconductors: the Heusler compound Mn₂CoAl / S. Ouardi, G.H. Fecher, C. Felser, J. Kubler // J.: Phys. Rev. Lett. – 2019. – Vol. 122. – P. 059901(E).

35. Nawa, K. Exploring half-metallic Co-based full Heusler alloys using a DFT+U method combined with linear response approach / K. Nawa, Y. Miura // RSC Adv. – 2019. – Vol. 9. – P. 30462.

36. Chen, X.-Q. Ab initio prediction of half-metallic properties for the ferromagnetic Heusler alloys Co₂*M*Si (*M*=Ti, V, Cr) // X.-Q. Chen, R. Podloucky, P. Rogl // J. Appl. Phys. – 2006. – Vol. 100. – P. 113901.

37. Electronic structure and vibrational properties in cobalt-based full-Heusler compounds: A first principle study of Co₂Mn*X* (*X* = Si, Ge, Al, Ga) / A. Candan, G. Ugur, Z. Charifi, H. Baaziz, M.R. Ellialtioglu // J. Alloys Compd. – 2013. – Vol. 560. – P. 215.
38. Perdew, J.P. Generalized gradient approximation made simple // J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof // Phys. Rev. Lett. – 1996. – Vol. 77. – P. 3865.

Quantum espresso: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials / P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G.L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, A.D. Corso, S. de Gironcoli, S. Fabris, G. Fratesi, R. Gebauer, U. Gerstmann, C. Gougoussis, A. Kokalj, M. Lazzeri, L. Martin-Samos, N. Marzari, F. Mauri, R. Mazzarello, S. Paolini, A. Pasquarello, L. Paulatto, C. Sbraccia, S. Scandolo, G. Sclauzero, A.P. Seitsonen, A. Smogunov, P. Umari, R.M. Wentzcovitch // J. Phys.: Condens. Matter. – 2009. – Vol. 21. – P. 395502.

40. Galanakis, I. Heusler alloy. Theory of Heusler and full-Heusler compounds / I. Galanakis, by editorial A. Hirohata and C. Felser. – Springer International Publishing Switzerland, 2016. – 486 p.

41. Structural stability and magnetic properties of Mn_2FeAl alloy with a β -Mn structure / S. Dash, A.V. Lukoyanov, Nancy, D. Mishra, U.P.M. Rasi, R.B.

Gangineni, M. Vasundhara, A.K. Patra // J. Magn. Magn. Mater. – 2020. – Vol. 513. – P. 167205.

42. Коуров, Н.И. Особенности электросопротивления полуметаллических ферромагнитных сплавов Co₂CrAl и Co₂CrGa / Н.И. Коуров, А.В. Лукоянов, В.В. Марченков // ΦTT. – 2013. – Т. 55. – С. 2366.

43. Beattie, J.R. Optical constants of metals in the infra-red – experimental methods /
J.R. Beattie, G.K.T. Conn // Phil. Magaz. – 1955. – Vol. 46. – P. 235.

44. Beattie, J.R. Optical constants of metals in the infra-red – principles of measurement / J.R. Beattie, G.K.T. Conn // Phil. Magaz. – 1955. – Vol. 46. – P. 222.

45. Соколов, А.В. Оптические свойства металлов / А.В. Соколов. – Москва: Физматгиз, 1961. – 464 с.

46. Shreder, E.I. Optical and electrical properties and electronic structure of Co_2MnZ (Z = Al, Ga, Si, Sn, Sb) / E.I. Shreder, M.M. Kirillova, V.P. Dyakina // Phys. Met. Metallogr. – 1996. – Vol. 81 – P. 406.

47. Electrical and optical properties of X_2YZ (X = Co, Fe; Y = Cr, Mn, Ti; Z = Ga, Al, Si) Heusler alloys / K.A. Fomina, V.V. Marchenkov, E.I. Shreder, H.W. Weber // Solid State Phenom. – 2011. – Vol. 168. – P. 545.

48. Уэрт, Ч.А. Физика твердого тела / Ч. А. Уэрт, Р. М. Томсон; Пер. с англ. А. С. Пахомова и Б. Д. Сумма; под ред. С. В. Тябликова. - 2-е изд. - Москва: Мир, 1969. - 558 с.

49. Zagrebin, M.A. Electronic and magnetic properties of the Co₂-based Heusler compounds under pressure: first-principles and Monte Carlo studies / M.A. Zagrebin, V.V. Sokolovskiy, V.D. Buchelnikov // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2016. – Vol. 49. – P. 355004.

50. Гальваномагнитные свойства сплавов Гейслера Co₂YAl (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni) / Н.И. Коуров, В.В. Марченков, Ю.А. Перевозчикова, Н.W. Weber // ФТТ. – 2017. – Т. 59. – С. 63.

51. Особенности электросопротивления полуметаллических ферромагнетиков Co₂MeAl (Me = Ti, V, Cr, Mn, Fe) / Н.И. Коуров, Ю.А. Перевозчикова, Н.W. Weber, В.В. Марченков // ФТТ. – 2016. – Т. 58. – С. 1311.

52. Features of electronic properties of band ferromagnets Co₂*Me*Al and Fe₂*Me*Al (*Me*=Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni) / N.I. Kourov, V.V. Marchenkov, A.V. Korolev, A.V. Lukoyanov, A.A. Shirokov, Yu. A. Perevozchikova // Mater. Res. Express. – 2017. – Vol. 4. – P. 116102.

53. Вонсовский, С.В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков / С.В. Вонсовский. – М.: Наука, гл. ред. физ.-матем. лит., 1971. – 1032 с.

54. Определение коэффициентов нормального и аномального эффектов Холла в ферромагнитных сплавах Гейслера Ni₄₅Mn₃₅In_{15-x}Si_x при мартенситном превращении / А.Б. Грановский, В.Н. Прудников, А.П. Казаков, А.П. Жуков, И.С. Дубенко // ЖЭТФ. – 2012. – Т. 142. – С. 916.

55. Takahashi, Y.K. Heusler alloy. Spin polarization in Heusler alloy films / Y.K. Takahashi, K. Hono, by editorial A. Hirohata and C. Felser. – Springer International Publishing Switzerland, 2016. – 486 p.

56. Observation of Electron Polarization in Photoemission / G. Busch, M. Campagna,
P. Cotti, and H.C. Siegmann // Phys. Rev. Lett. – 1969. – Vol. 22. – P. 597.

57. Magnetic properties and phase stability of Co₂Cr(Ga,Si) Heusler alloys / R.Y.
Umetsu, A. Okubo, X. Xu, R. Kainuma // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 588. – P. 153.
58. Temperature dependence of a resonance frequency of 59Co NMR in a ferromagnetic Heusler alloy Co₂FeSi / H. Nishihara, N. Okui, A. Okubo, T. Kanomata, R.Y. Umetsu, R. Kainuma, T. Sakon // J. Alloys Compd. – 2013. – Vol. 551. – P. 208.

59. Tailoring the electronic structure of half-metallic Heusler alloys / P. Klaer, M. Kallmayer, C.G.F. Blum, T. Graf, J. Barth, B. Balke, G.H. Fecher, C. Felser, H.J. Elmers // Phys. Rev. B. – 2009. – Vol. 80. – P. 144405.

60. Kandpal, H.C. Calculated electronic and magnetic properties of the halfmetallic, transition metal based Heusler compounds / H.C. Kandpal, G.H. Fecher, C. Felser // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2007. – Vol.40. – P. 1507.

61. Uhl, E. The ferromagnetic and paramagnetic properties of Heusler alloys $(Ni_{1-x}Co_x)_2MnSn / E$. Uhl // J. Solid State Chem. – 1982. – Vol. 43. – P. 354.
62. Temperature breakdown phenomenon in tungsten single crystals at high magnetic fields / V.V. Marchenkov, A.N. Cherepanov, V.E. Startsev, C. Czurda, H.W. Weber // J. Low Temp. Phys. – 1995. – Vol. 98. – P. 425.

63. Experimental verification and quantitative analysis of the temperature (phonon) breakdown phenomenon in the high-field magnetoresistivity of compensated metals // V.V. Marchenkov, H.W. Weber, A.N. Cherepanov, V.E. Startsev // J. Low Temp. Phys. – 1996. – Vol. 102. – P. 133.

64. Эффект Холла при статическом скин-эффекте / Н.В. Волкенштейн, В.В. Марченков, В.Е. Старцев, А.Н. Черепанов, М. Глиньски // Письма в ЖЭТФ. – 1985.
− Т. 41. – С. 376.

65. Characteristics of galvanomagnetic properties of compensated metals under static skin effect conditions in strong magnetic fields (tungsten) / N.V. Volkenshtein, M. Glinski, V.V. Marchenkov, V.E. Startsev, and A. N. Cherepanov // Zh. Eksp. Teor. Fiz. – 1989. – Vol. 95. – P. 2103.

66. Гальваномагнитные свойства сплавов Гейслера Fe_2YZ (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni; Z = Al, Si) / H.И. Коуров, В.В. Марченков, К.А. Белозерова, H.W. Weber // ЖЭТФ. – 2015. – Т. 148. – С. 966.

67. Шредер, Е.И. Оптические свойства и электронные характеристики сплавов Гейслера и полуметаллических ферромагнетиков на основе переходных dметаллов: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Шредер Елена Ивановна. – Екатеринбург, 1998. – 152 с.

68. Гантмахер, В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах / В.Ф. Гантмахер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 232 с.

69. Особенности электрических свойств ферромагнитных сплавов Гейслера Ni₂MnGa и Co₂CrGa / Н.И. Коуров, В.В. Марченков, В.Г. Пушин, К.А. Белозерова // ЖЭТФ. – 2013. – Т. 144. – С. 141.

Mooij, J.H. Electrical conduction in concentrated disordered transition metal alloys
/ Mooij, J.H. // Phys. Stat. Sol. (a). – 1973. – Vol. 17. – P. 521.

71. Kostenko, M.G. Structural disorder and short-range order in full Heusler alloys Fe₂VAl and Co₂CrAl from first principles calculations / M.G. Kostenko, A.V. Lukoyanov // Mater. Chem. Phys. – 2020. – Vol. 239. – P. 122100.

72. Enhancement of spin polarization via Fermi level tuning in $Co_2MnSn_{1-x}Sb_x$ (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) Heusler alloys / M. Singh, H.S. Saini, J. Thakur, M.K. Kashyap // AIP Conf. Proc. – 2014. – Vol. 1591. – P. 1606.